

7 V~76 V 入力 5 A 上側 MOSFET 内蔵 1ch 降圧 DC/DC コンバータ

BD9G500EFJ-LA

概要

本製品は産業機器市場へ向けた、長期の供給を保障するランクの製品です。これらのアプリケーションとして、ご使用される場合に最適な商品です。

BD9G500EFJ-LA は低 ON 抵抗の上側パワー MOSFET を内蔵した 1ch 降圧 DC/DC コンバータです。最大 5A の電流を出力することが可能です。電流モード制御 DC/DC コンバータのため高速な過渡応答性能を持ち、位相補償についても容易に設定することが可能です。周波数は 100 kHz ~ 650 kHz まで調節可能です。

重要特性

- 入力電圧範囲 : 7 V ~ 76 V
- 入力絶対最大定格電圧 : 80 V
85 V (1 ms パルス、50 % DUTY 以下)
- 基準電圧精度 : 1.0 V ± 1.0 %
- 出力電流 : 5 A (Max)
- 上側 MOSFET ON 抵抗 : 100 mΩ (Typ)
- シャットダウン時回路電流 : 0 μA (Typ)
- 動作温度範囲 : -40 °C ~ +125 °C

特長

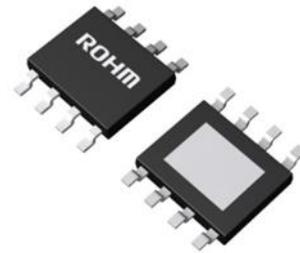
- 産業機器に適した長期の供給保証
- 広い入力範囲に対応
- 上側パワー MOSFET 内蔵
- 電流モード制御
- 周波数可変
- ソフトスタート機能
- 過電流保護機能 (OCP)
- 低入力電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 温度保護機能 (TSD)
- 出力過電圧保護機能 (OVP)
- HTSOP-J8 パッケージ

パッケージ

HTSOP-J8

W (Typ) x D (Typ) x H (Max)

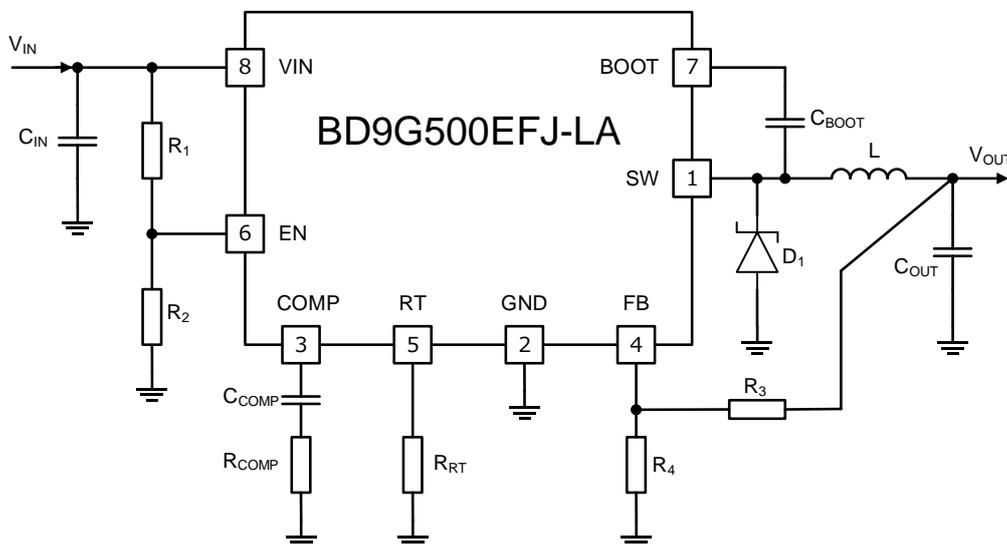
4.9 mm x 6.0 mm x 1.0 mm



用途

- 産業機器
- FA 用産業機器向け電源
- 通信機器

基本アプリケーション回路



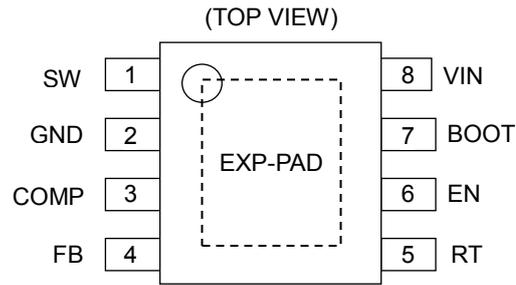
○製品構造：シリコンを主材料とした半導体集積回路 ○耐放射線設計はしていません

www.rohm.co.jp

© 2020 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

TSZ22111 • 14 • 001

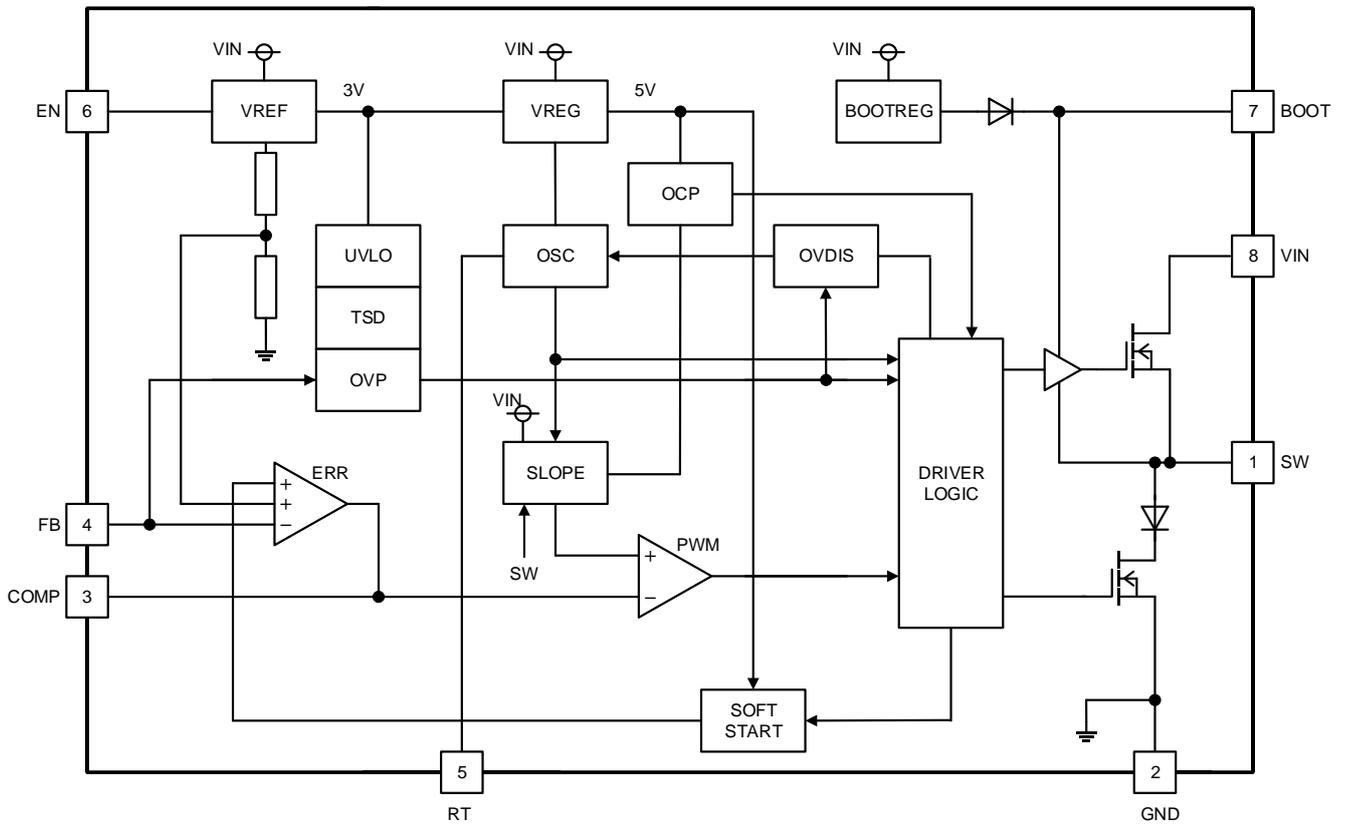
端子配置図



端子説明

端子番号	端子名	機能
1	SW	スイッチ端子です。上側 MOSFET のソースに接続されています。 この端子と GND 端子間にショットキーバリアダイオードを接続してください。
2	GND	グラウンド端子です。
3	COMP	gm エラーアンプの出力及び PWM コンパレータの入力端子です。 この端子に 位相補償部品 を接続します。
4	FB	出力電圧フィードバック端子です。出力電圧の設定方法は アプリケーション部品選定方法 出力電圧設定 項目を参照してください。
5	RT	内部周波数設定端子です、対グラウンドに抵抗を接続して内部周波数を設定します。 周波数可変範囲は 100 kHz ~ 650 kHz です。
6	EN	この端子を Low (0.4 V 以下) にすると、デバイスが強制的にシャットダウンモードに入り、 High (2.5 V 以上) にすると、デバイスがイネーブルになります。この端子は終端する必要があります。
7	BOOT	ブートストラップ用端子です。この端子と SW 端子の間にブートストラップコンデンサ 1 μ F を接続します。この端子の電圧が上側 MOSFET のゲート駆動電圧になります。
8	VIN	電源入力端子です。 この端子はスイッチングレギュレータ出力段及び制御用回路に電源を供給します。 推奨値として 15 μ F と 1 μ F のセラミック・コンデンサを接続してください。
-	EXP- PAD	裏面放熱用パッドです。サーマルビアを使用して、PCB 内のグラウンドプレーンに接続することで優れた放熱特性が得られます。

ブロック図



各ブロック動作説明

- 1 **VREF**
内部基準電圧 3 V (Typ) を生成するブロックです。
- 2 **VREG**
内部基準電圧 5 V (Typ) を生成するブロックです。
- 3 **BOOTREG**
ゲート駆動電圧を生成するブロックです。
- 4 **TSD**
温度保護ブロックです。温度保護回路は IC 内部が 175 °C (Typ) 以上になると IC をシャットダウンします。温度が低下すると、25 °C (Typ) のヒステリシスをもって復帰します。
- 5 **UVLO**
低電圧誤動作防止ブロックです。VIN 端子電圧が 6.4 V (Typ) 以下になると IC をシャットダウンします。本スレシヨルド電圧は 200 mV (Typ) のヒステリシスをもっています。
- 6 **ERR**
基準電圧と出力電圧のフィードバック電圧を比較する誤差増幅器です。ERR アンプの出力 (COMP 端子電圧) により、スイッチングデューティが決定されます。
- 7 **OSC**
発振周波数を生成するブロックです。
- 8 **SLOPE**
OSC にて生成されたクロックから三角波を生成し、上側 MOSFET の電流センス信号と三角波を合成します。
- 9 **PWM**
誤差増幅器の出力 COMP 端子電圧と、SLOPE 部の信号を比較し、スイッチングデューティを決定します。
- 10 **DRIVER LOGIC**
DC/DC ドライバを制御する回路です。PWM からの信号を入力し、MOSFET を駆動します。
- 11 **SOFT START**
ソフトスタート回路です。起動時、緩やかに出力電圧を立ち上げ、出力電圧のオーバーシュートや突入電流を防ぎます。
- 12 **OCP**
過電流時、上側 MOSFET に流れる電流をスイッチングの 1 周期ごとに制限します。過電流状態を 4 回連続検出すると、20 ms (Typ) 間動作を停止し、その後再起動します。
- 13 **OVP**
過電圧保護機能は、FB 端子電圧が 1.2 V (Typ) 以上になると、上側 MOSFET を OFF します。FB 端子電圧が低下するとヒステリシスをもって復帰します。本 IC はディスチャージ MOS を内蔵し、毎周期に 1 回 100 ns (Typ) ON します。FB 端子電圧が 2.0 V (Typ) 以上になると、ディスチャージ MOS も OFF します。
- 14 **OVDIS**
FB 端子電圧が 1.0 V (Typ) 以上、2.0 V (Typ) 以下の状態が 16 周期を継続すると、ディスチャージ MOS の ON 時間を 400 ns (Typ) にし、出力をディスチャージします。

絶対最大定格 (Ta = 25 °C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V _{IN}	-0.3 ~ +80.0	V
電源電圧 (1 ms パルス、50 % DUTY 以下)	V _{INPULSE}	-0.3 ~ +85.0	V
EN 端子電圧	V _{EN}	-0.3 ~ +80.0	V
BOOT-GND 間電圧	V _{BOOT}	-0.3 ~ +85.0	V
BOOT-SW 間電圧 ^(Note 1)	ΔV _{BOOT-SW}	-0.3 ~ +7.0	V
FB 端子電圧	V _{FB}	-0.3 ~ +7.0	V
COMP 端子電圧	V _{COMP}	-0.3 ~ +7.0	V
RT 端子電圧	V _{RT}	-0.3 ~ +7.0	V
SW 端子電圧	V _{SW}	-0.5 ~ V _{IN} + 0.3	V
最高接合部温度	T _{jmax}	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

注意 1: 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただくようご検討をお願いします。

注意 2: 最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

(Note 1) この IC は BOOT-SW 間電圧の絶対最大定格が 7.0 V となるため、起動後に VIN 端子 と BOOT 端子をショートさせないでください。

熱抵抗^(Note 2)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1 層基板 ^(Note 4)	4 層基板 ^(Note 5)	
HTSOP-J8				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ _{JA}	112.8	24.3	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ ^(Note 3)	Ψ _{JT}	6.0	2.0	°C/W

(Note 2) JESD51-2A (Still-Air) に準拠。

(Note 3) ジャンクションからパッケージ (モールド部分) 上面中心までの熱特性パラメータ。

(Note 4) JESD51-3 に準拠した基板を使用。

(Note 5) JESD51-5,7 に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1 層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.57 mmt

1 層目 (表面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μm

測定基板	基板材	基板寸法	サーマルビア ^(Note 6)	
			ピッチ	直径
4 層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.6 mmt	1.20 mm	Φ0.30 mm

1 層目 (表面) 銅箔		2 層目、3 層目 (内層) 銅箔		4 層目 (裏面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μm	74.2 mm□ (正方形)	35 μm	74.2 mm□ (正方形)	70 μm

(Note 6) 貫通ビア。全層の銅箔と接続する。配置はランドパターンに従う。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V _{IN}	7	-	76	V
動作温度	Topr	-40	-	+125 ^(Note 1)	°C
出力電流	I _{OUT}	0	-	5	A
出力電圧設定範囲	V _{RANGE}	1.0 ^(Note 2)	-	0.97 × V _{IN} ^(Note 3)	V

(Note 1) 実動作環境下で T_j < 150 °C となるようご使用ください。

(Note 2) 出力パルス幅が 350 ns (Typ) 以上となる出力電圧設定でご使用ください。

(Note 3) f_{OSC} = 200 kHz 設定時、出力電圧の最大値が 0.97 (Typ) × (V_{IN} - R_{ONH} × I_{OUT}) となります。

電気的特性 (特に指定のない限り T_j = -40 °C ~ +125 °C, V_{IN} = 48 V, V_{EN} = 3 V)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
Operating Supply Current	I _{OPR}	-	0.75	1.50	mA	V _{FB} = 3.0 V T _j = 25 °C
Shutdown Current	I _{SD}	-	0	10	μA	V _{EN} = 0 V T _j = 25 °C
FB Threshold Voltage ^(Note 4)	V _{FB}	0.99	1.00	1.01	V	
FB Input Current	I _{FB}	-0.1	0	+0.1	μA	V _{FB} = 1.1 V
Switching Frequency Range Using RT Pin	f _{RTOSC}	100	-	650	kHz	T _j = 25 °C
Switching Frequency	f _{OSC}	180	200	220	kHz	T _j = 25 °C RT = 47 kΩ
High-Side MOSFET ON-Resistance	R _{ONH}	-	100	140	mΩ	I _{SW} = -50 mA T _j = 25 °C
Over Current Limit ^(Note 5)	I _{LIMIT}	6.4	8.0	-	A	Without switching Open Loop
UVLO Threshold Voltage	V _{UVLO}	6.1	6.4	6.7	V	V _{IN} falling
UVLO Hysteresis Voltage	V _{UVLOHYS}	100	200	300	mV	
EN High-Level Input Voltage	V _{ENH}	2.5	-	-	V	
EN Low-Level Input Voltage	V _{ENL}	0	-	0.4	V	
EN Input Current	I _{EN}	1.15	2.30	4.60	μA	V _{EN} = 3 V T _j = 25 °C
Soft Start Time	t _{SS}	15	20	25	ms	

(Note 4) 実製品の出荷検査は T_j = 25 °C のみ実施しております。

(Note 5) 実製品の出荷検査は SW 端子電圧を測定しております。

特性データ (参考データ)

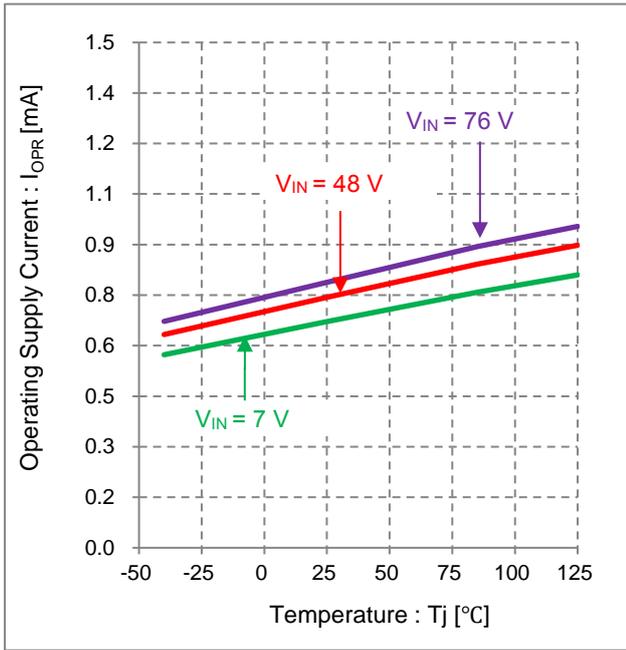


Figure 1. Operating Supply Current vs Temperature

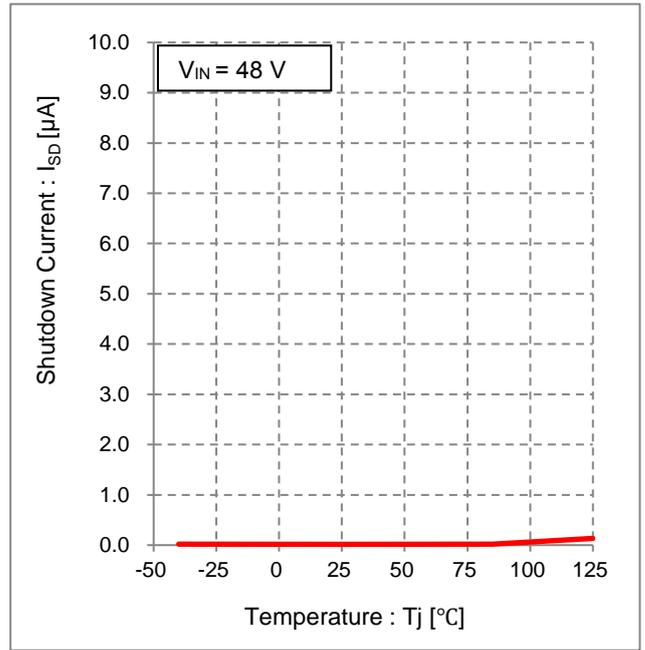


Figure 2. Shutdown Current vs Temperature

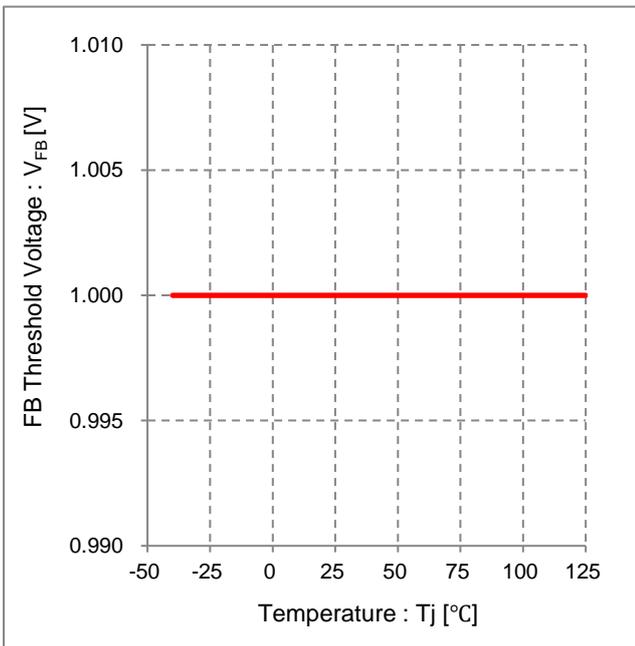


Figure 3. FB Threshold Voltage vs Temperature

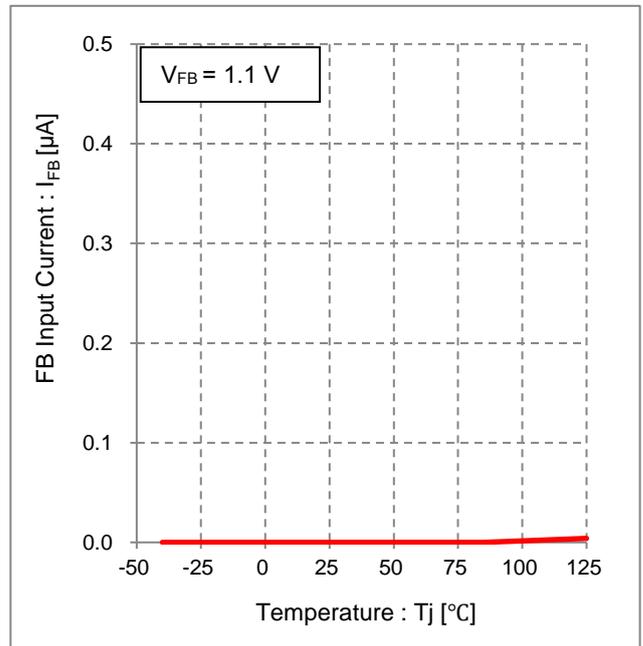


Figure 4. FB Input Current vs Temperature

特性データ (参考データ) - 続き

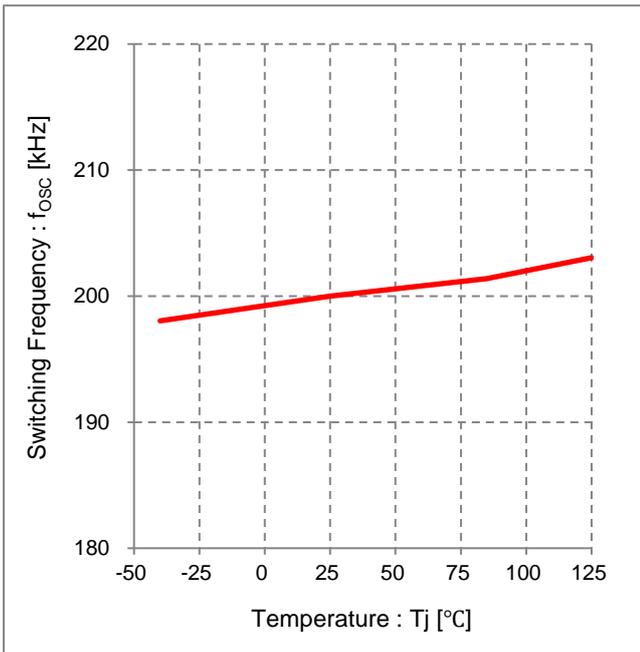


Figure 5. Switching Frequency vs Temperature

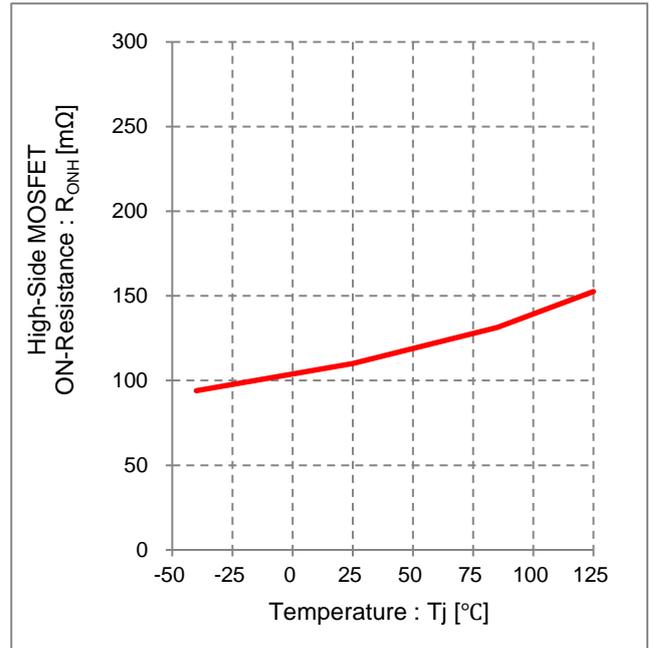


Figure 6. High-Side MOSFET ON-Resistance vs Temperature

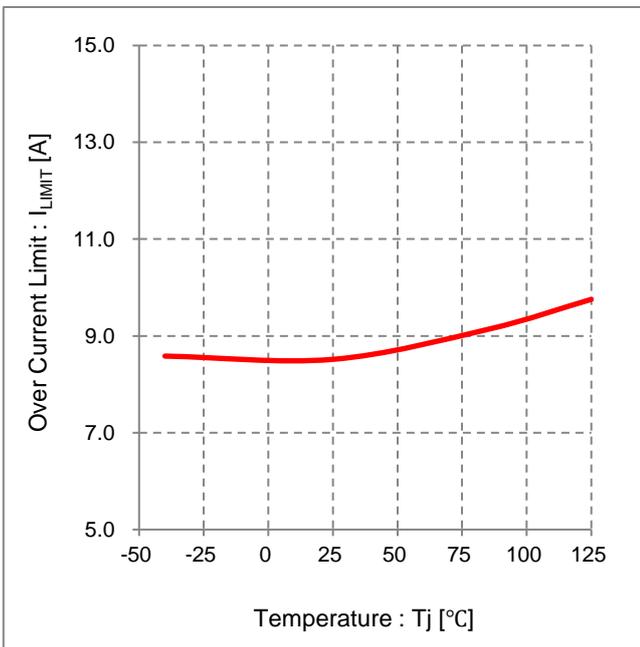


Figure 7. Over Current Limit vs Temperature

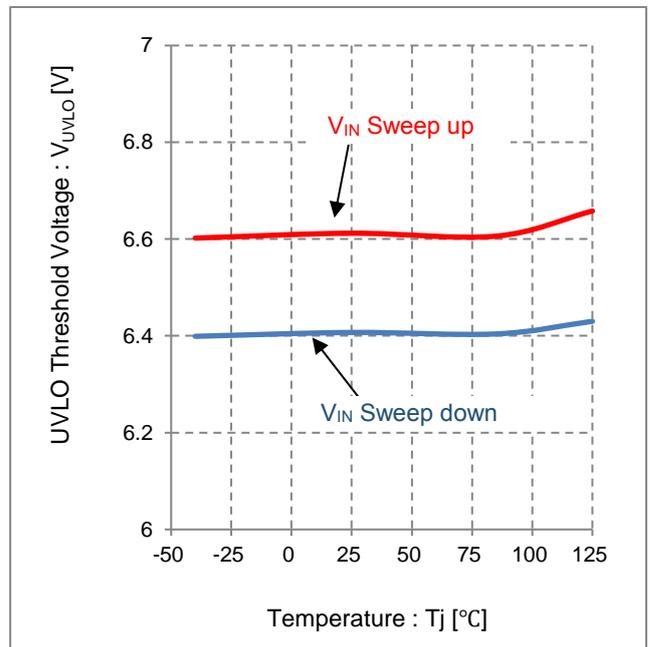


Figure 8. UVLO Threshold Voltage vs Temperature

特性データ (参考データ) - 続き

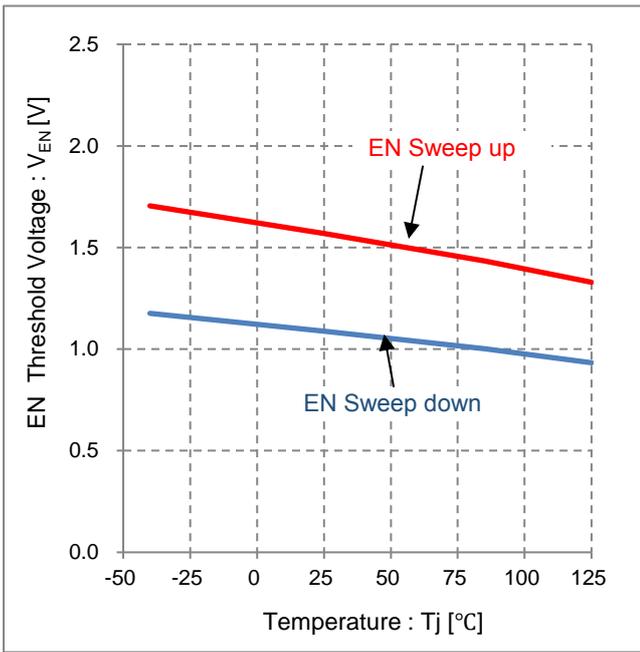


Figure 9. EN Threshold Voltage vs Temperature

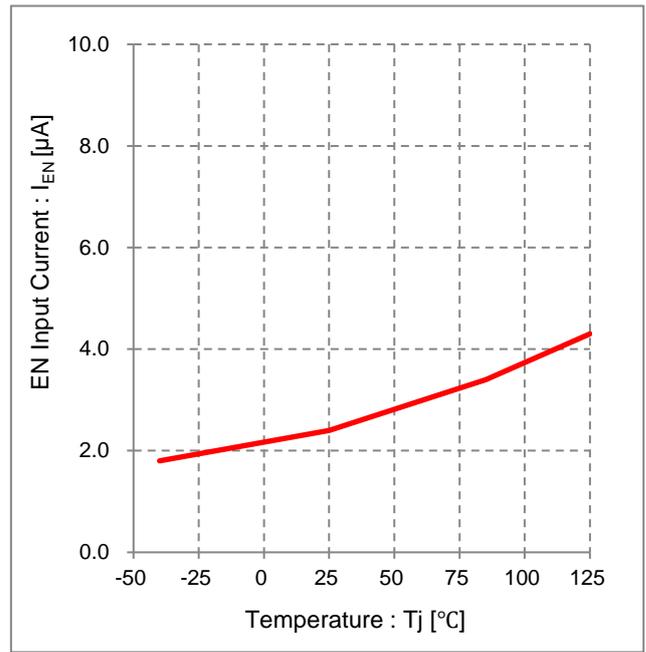


Figure 10. EN Input Current vs Temperature

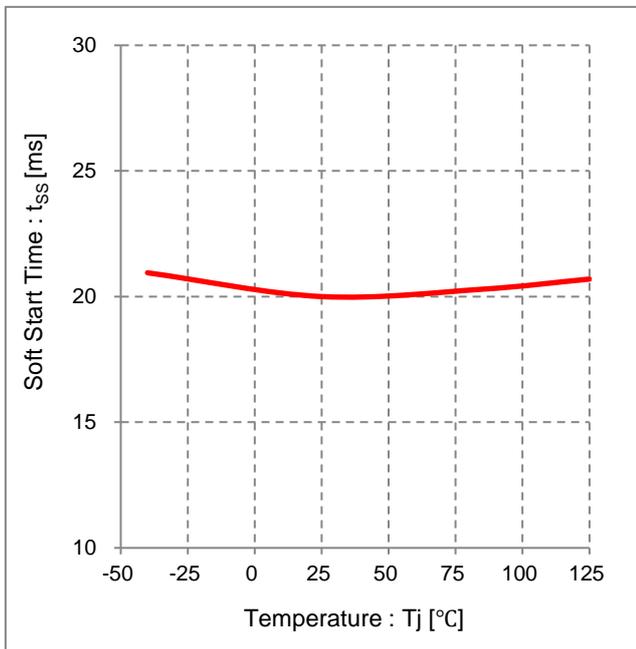


Figure 11. Soft Start Time vs Temperature

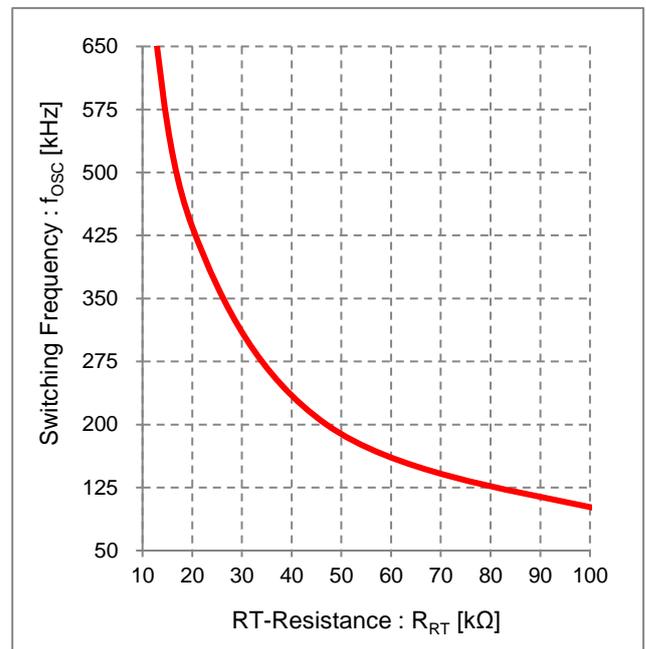


Figure 12. Switching Frequency vs RT-Resistance

アプリケーション特性データ (参考データ)

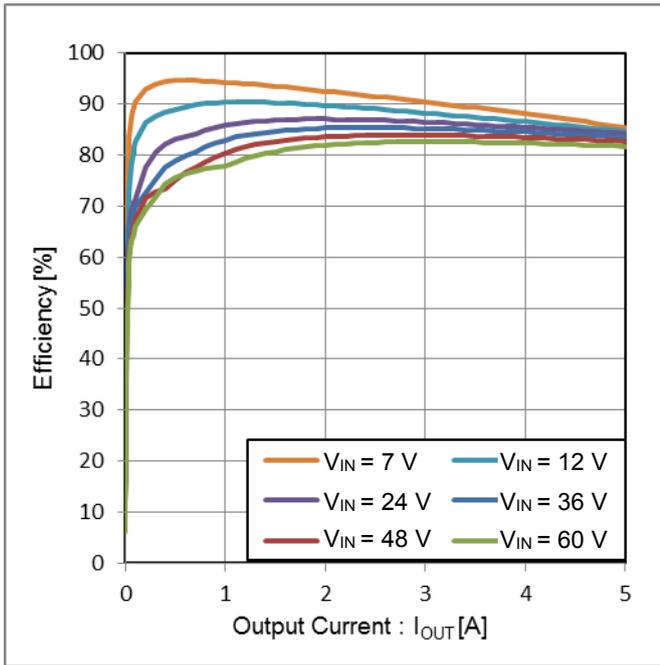


Figure 13. Efficiency vs Output Current
($V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 100\text{ kHz}$)

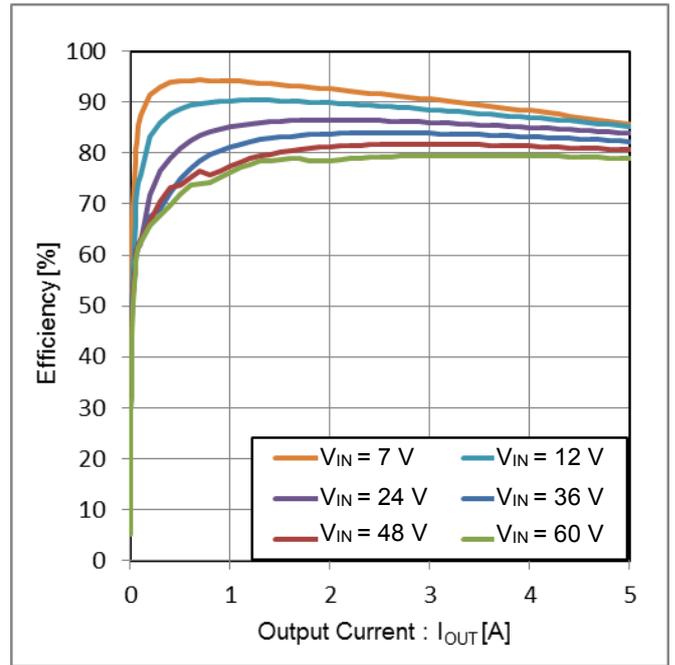


Figure 14. Efficiency vs Output Current
($V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$)

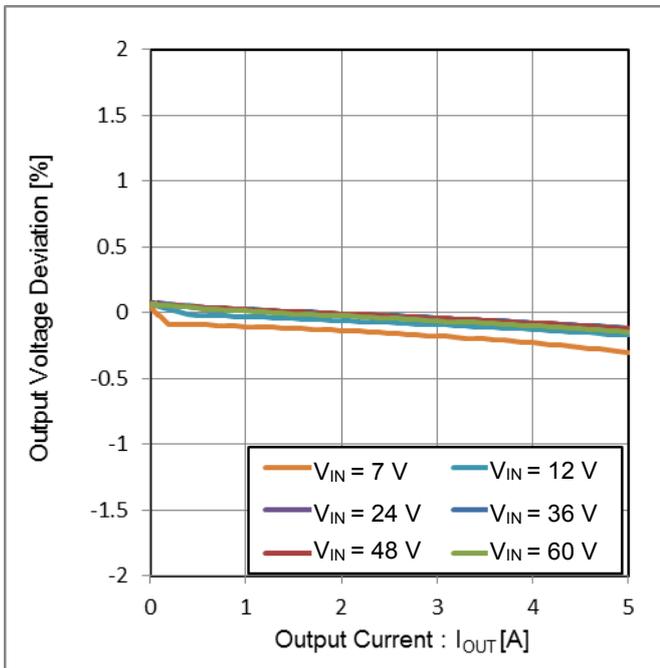


Figure 15. Output Voltage Deviation vs Output Current
(Load Regulation, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 100\text{ kHz}$)

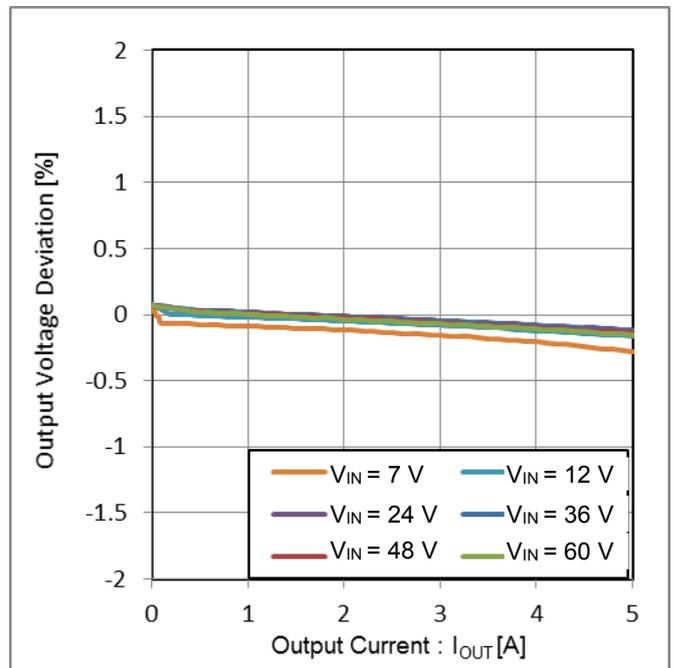


Figure 16. Output Voltage Deviation vs Output Current
(Load Regulation $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$)

アプリケーション特性データ(参考データ) — 続き

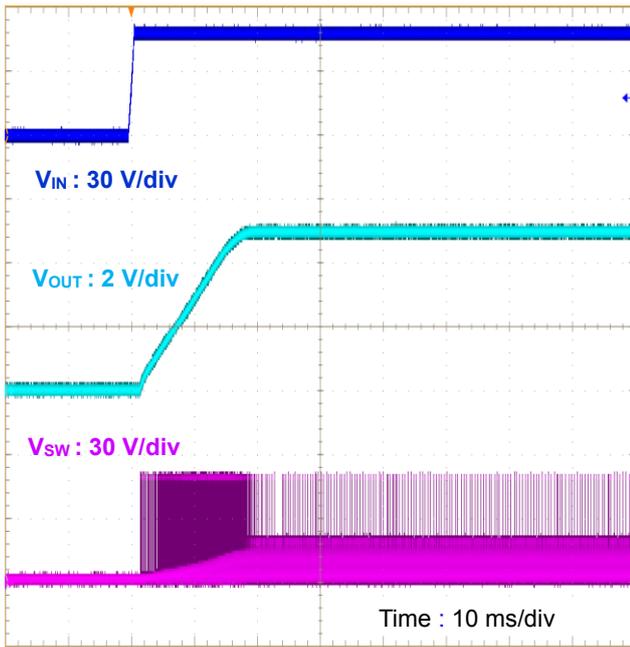


Figure 17. 起動波形
 ($V_{IN} = V_{EN}$, $V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, $I_{OUT} = 0\text{ A}$)

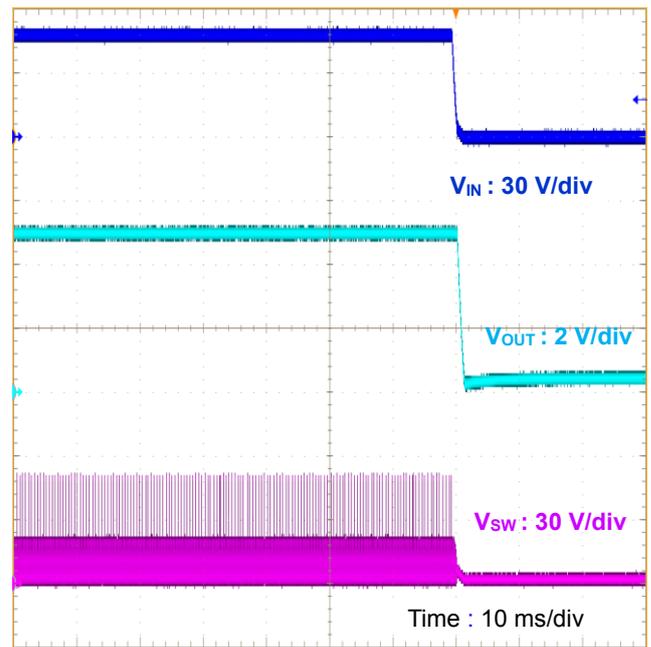


Figure 18. シャットダウン波形
 ($V_{IN} = V_{EN}$, $V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, $I_{OUT} = 0\text{ A}$)

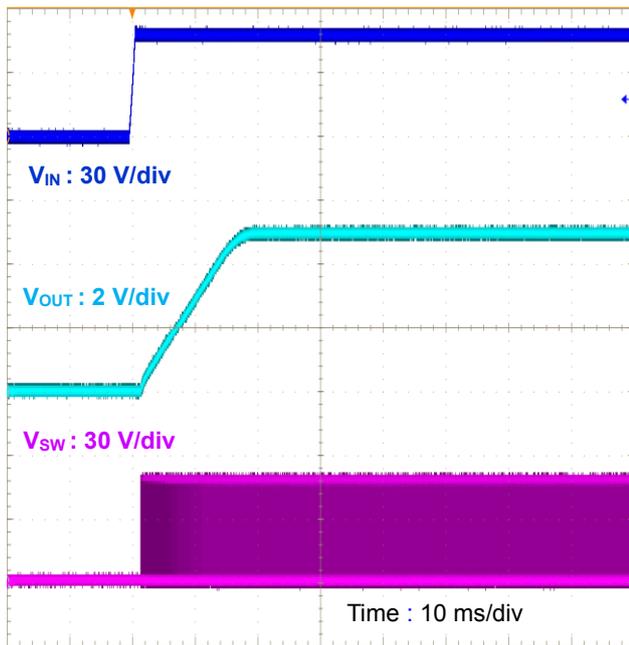


Figure 19. 起動波形
 ($V_{IN} = V_{EN}$, $V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, $I_{OUT} = 5\text{ A}$)

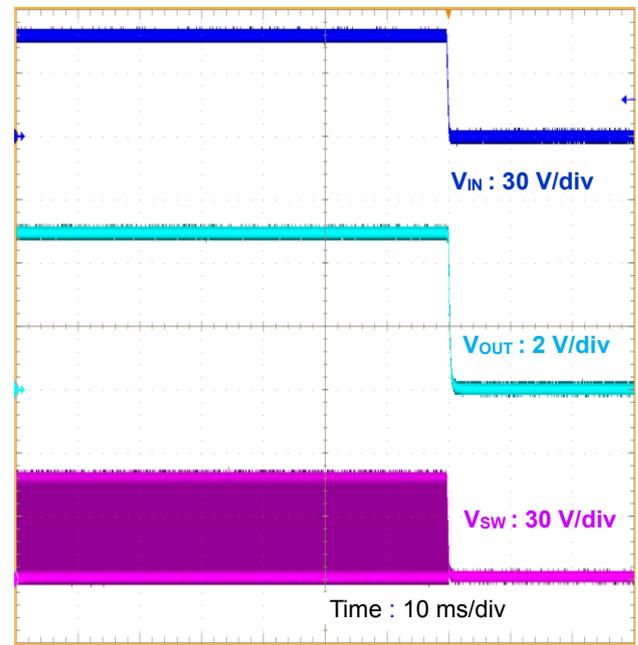


Figure 20. シャットダウン波形
 ($V_{IN} = V_{EN}$, $V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, $I_{OUT} = 5\text{ A}$)

アプリケーション特性データ(参考データ) — 続き

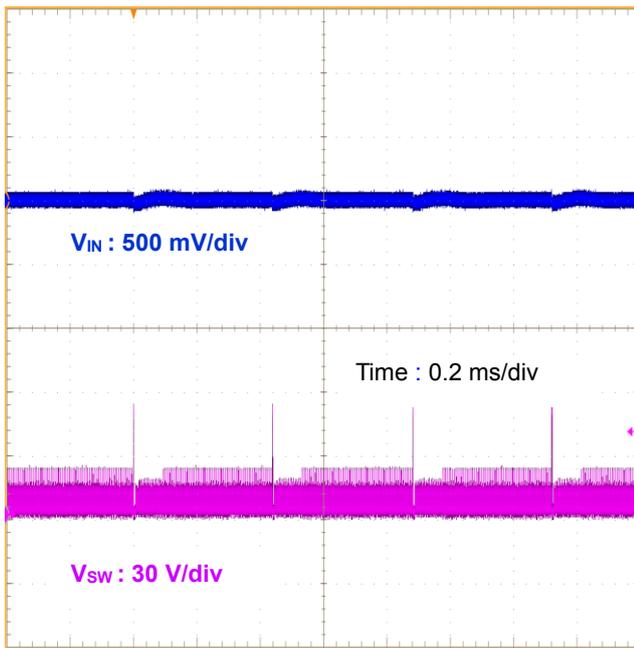


Figure 21. V_{IN} リップル波形
 ($V_{IN} = 48 \text{ V}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, $f_{osc} = 200 \text{ kHz}$, $I_{OUT} = 0 \text{ A}$)

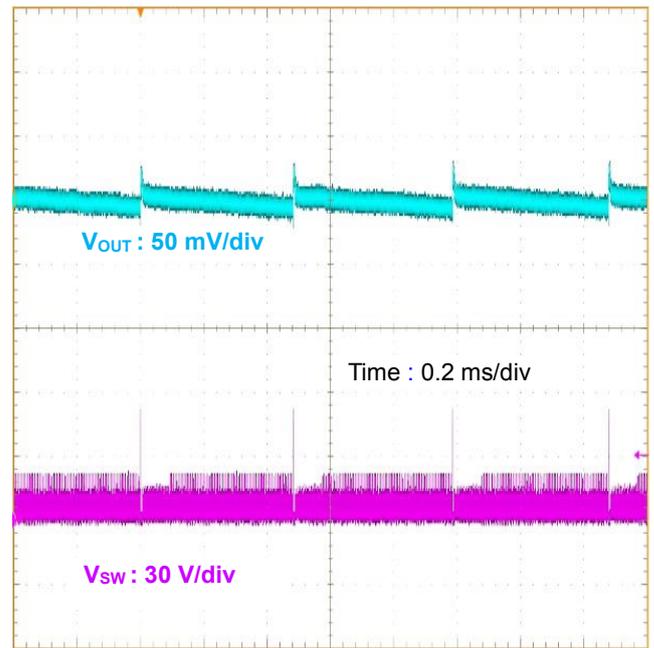


Figure 22. V_{OUT} リップル波形
 ($V_{IN} = 48 \text{ V}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, $f_{osc} = 200 \text{ kHz}$, $I_{OUT} = 0 \text{ A}$)

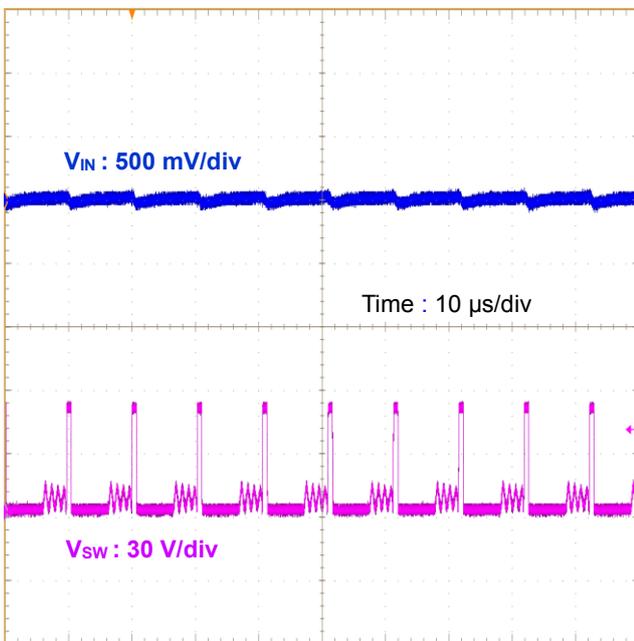


Figure 23. V_{IN} リップル波形
 ($V_{IN} = 48 \text{ V}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, $f_{osc} = 200 \text{ kHz}$, $I_{OUT} = 0.3 \text{ A}$)

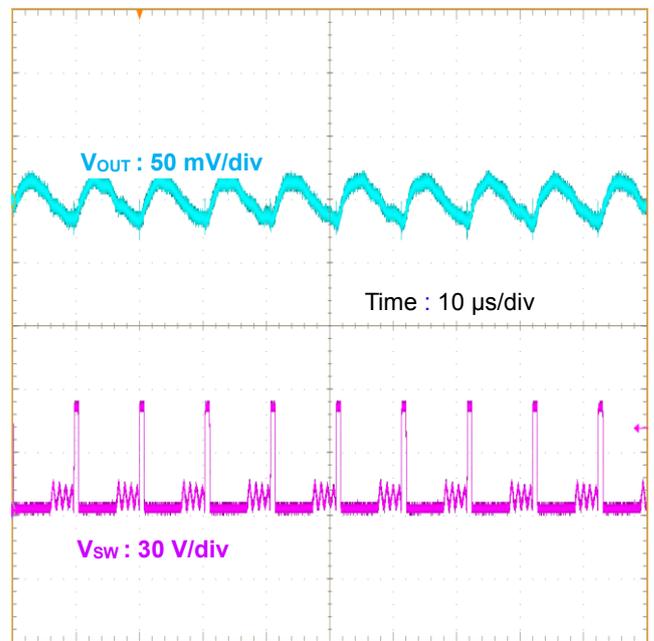


Figure 24. V_{OUT} リップル波形
 ($V_{IN} = 48 \text{ V}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, $f_{osc} = 200 \text{ kHz}$, $I_{OUT} = 0.3 \text{ A}$)

アプリケーション特性データ(参考データ) — 続き

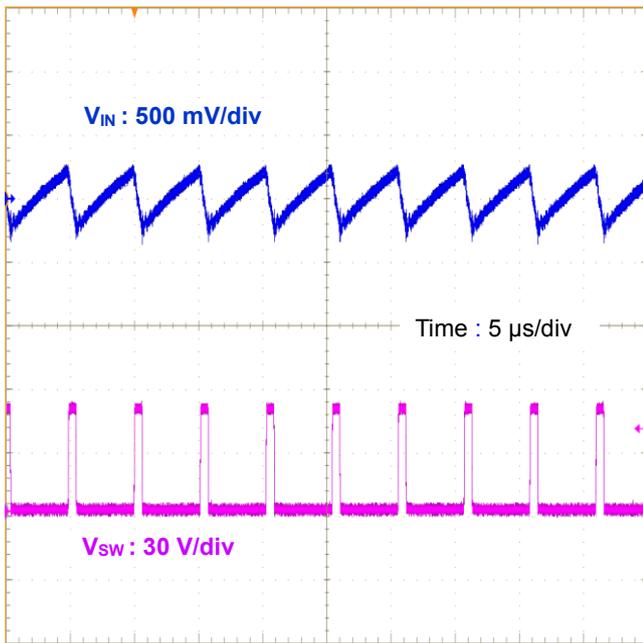


Figure 25. V_{IN} リップル波形
($V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, $I_{OUT} = 5\text{ A}$)

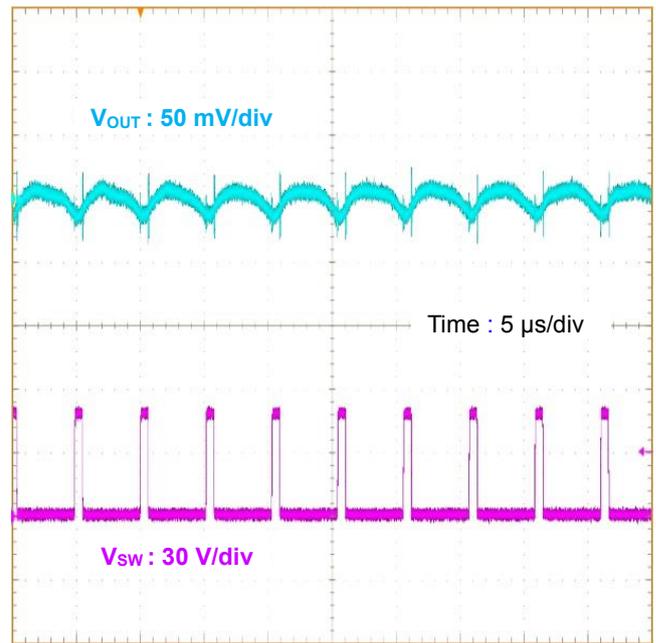


Figure 26. V_{OUT} リップル波形
($V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, $I_{OUT} = 5\text{ A}$)

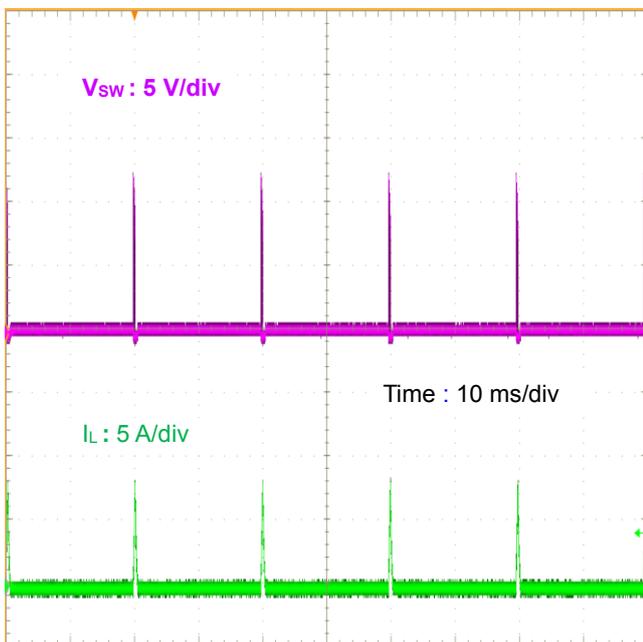


Figure 27. SW 波形
($V_{IN} = 12\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, V_{OUT} short to GND)

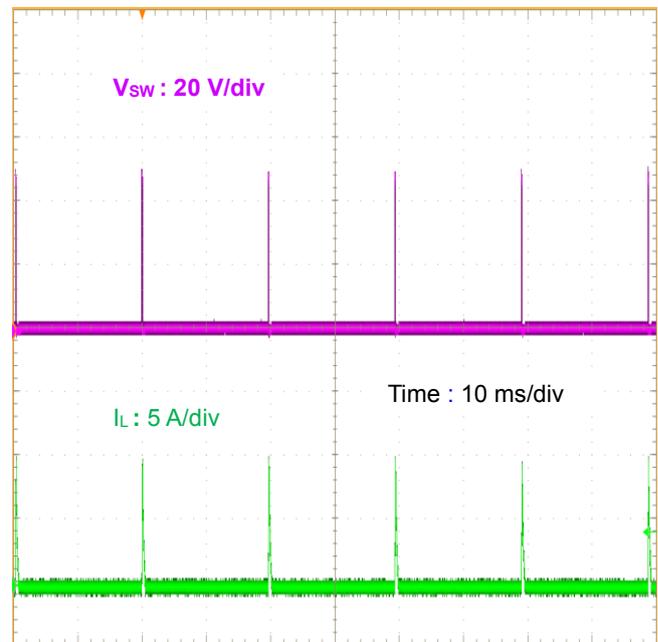


Figure 28. SW 波形
($V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, $f_{OSC} = 200\text{ kHz}$, V_{OUT} short to GND)

アプリケーション特性データ(参考データ) — 続き

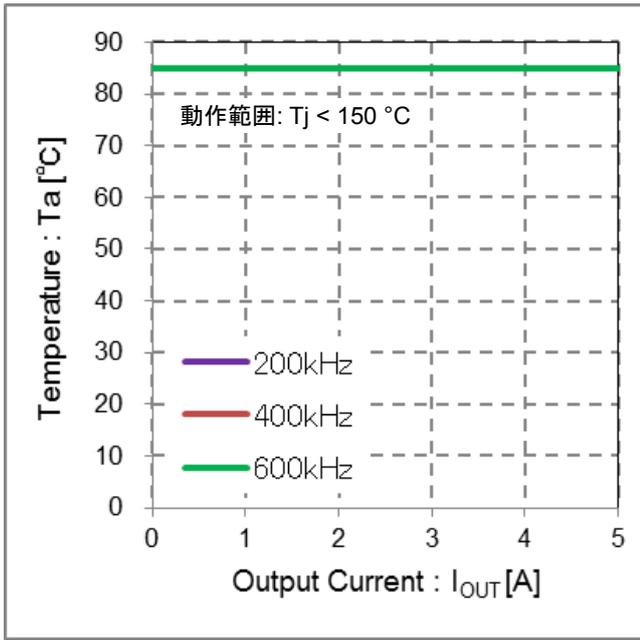


Figure 29. Temperature vs Output Current
($V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 5\text{ V}$, ROHM 評価ボード)

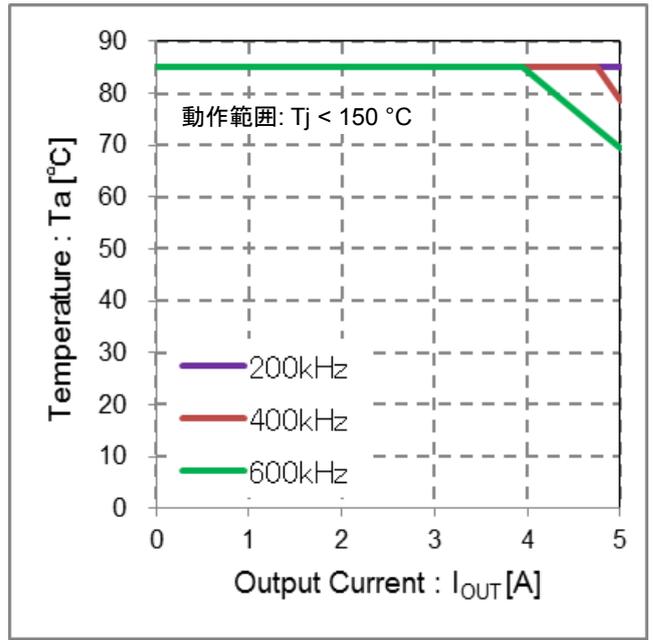


Figure 30. Temperature vs Output Current
($V_{IN} = 48\text{ V}$, $V_{OUT} = 12\text{ V}$, ROHM 評価ボード)

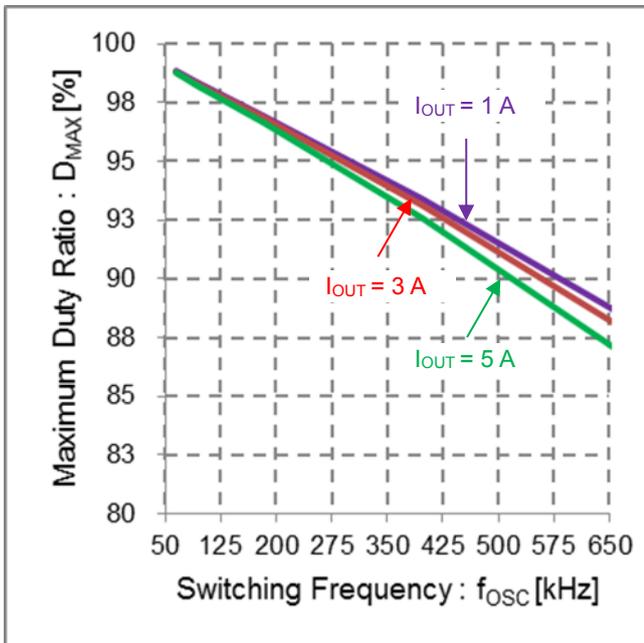


Figure 31. Maximum Duty Ratio vs Switching Frequency
($V_{IN} = 12\text{ V}$)

機能説明

1 イネーブル制御

EN 端子に印加される電圧によって、IC のシャットダウンをコントロールできます。V_{EN} が 2.5 V (Min) に達すると内部回路が動作し IC が起動します。V_{EN} を 0.4 V (Max) 以下にすると、デバイスがシャットダウンします。EN 端子にてシャットダウン制御を行う場合は、シャットダウン区間(EN の Low 区間)を 100 μs 以上に設定してください。

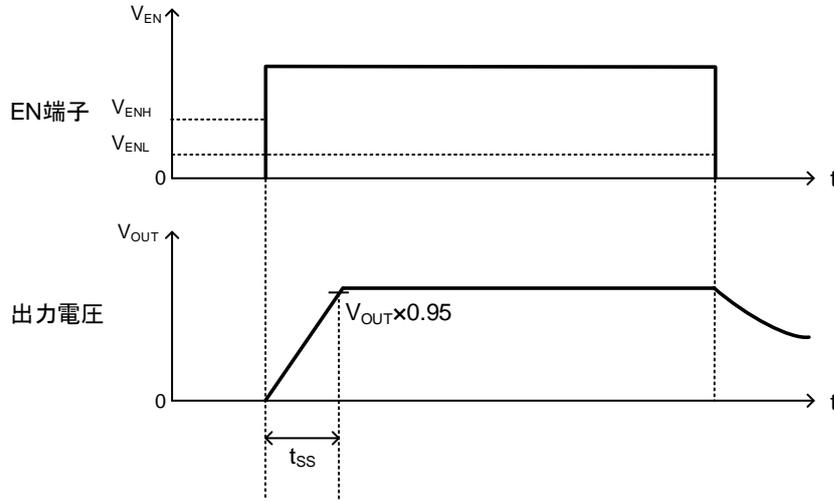


Figure 32. イネーブル制御タイミングチャート

2 保護機能

保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効であるため、保護動作の連続的な使用はしないでください。

2.1 過電流保護機能 (OCP)

過電流時、上側 MOSFET に流れる電流をスイッチング周波数の 1 周期ごとに制限します。過電流状態を 4 回連続検出すると、20 ms (Typ) 間動作を停止し、その後再起動します。

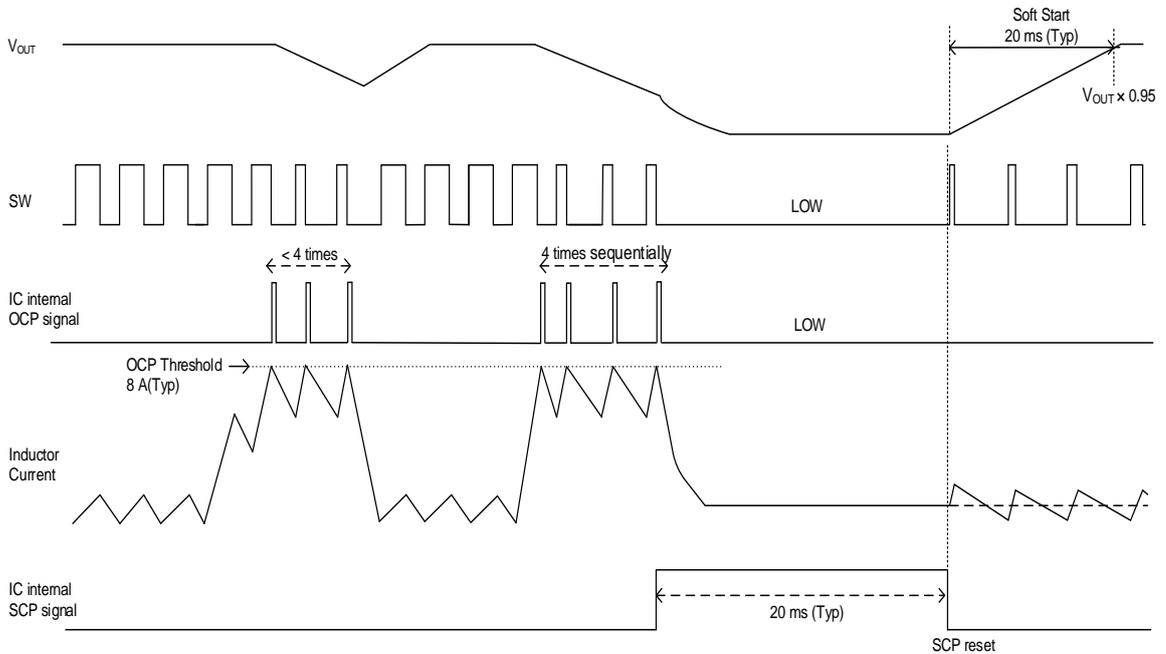


Figure 33. 過電流保護機能 (OCP) タイミングチャート

2 保護機能 — 続き

2.2 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)

低電圧誤動作防止回路は、VIN 端子電圧をモニタします。
VIN 端子電圧が 6.4 V (Typ) 以下の時、スタンバイ状態になります。
VIN 端子電圧が 6.6 V (Typ) 以上の時、起動動作になります。

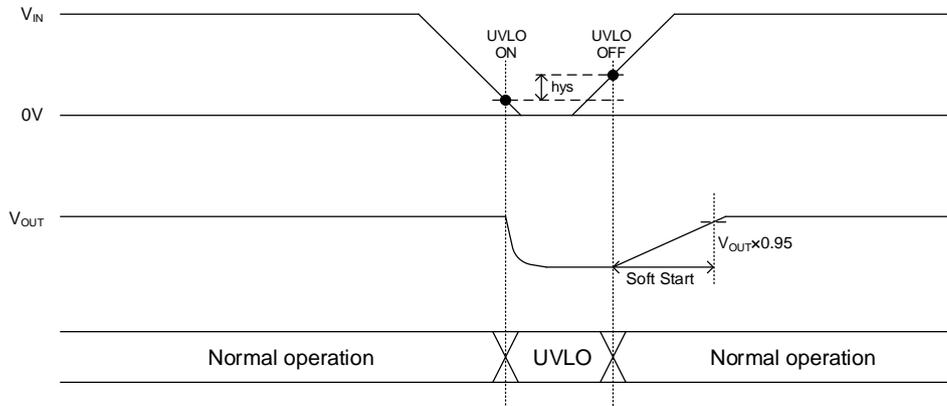


Figure 34. UVLO タイミングチャート

2.3 過電圧ディスチャージ機能 (OVDIS)

FB 端子電圧が 1.0 V (Typ) 以上、2.0 V (Typ) 以下の状態が 16 周期を継続すると、ディスチャージ MOS の ON 幅を 400 ns (Typ) にし、出力をディスチャージします。

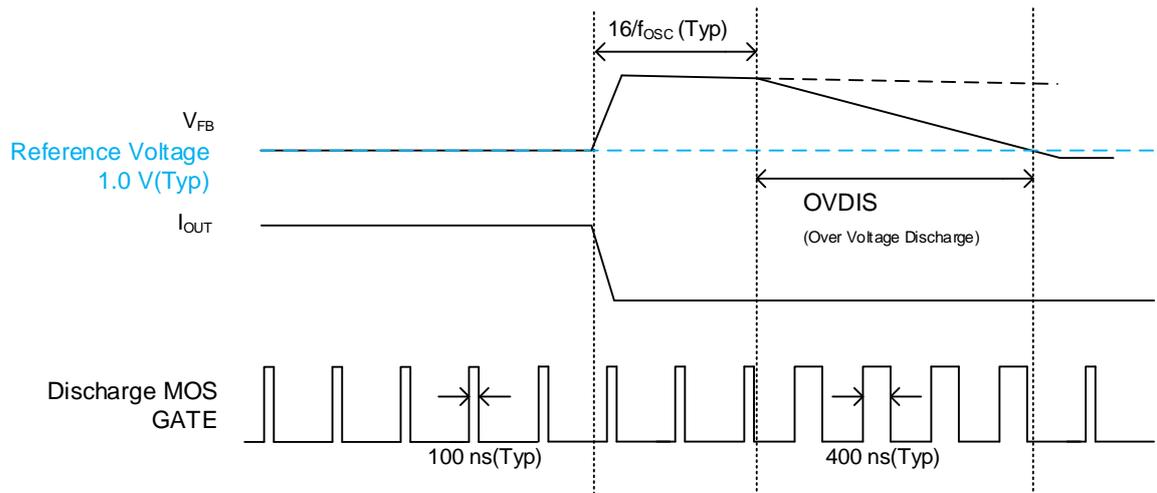


Figure 35. OVDIS タイミングチャート

2.4 過電圧保護機能 (OVP)

過電圧保護機能は、FB 端子電圧が 1.2 V (Typ) 以上になると、上側 MOSFET を OFF します。FB 端子電圧が低下するとヒステリシスを持って復帰します。本 IC はディスチャージ MOS を内蔵し、毎周期に 1 回 100 ns (Typ) ON します。FB 端子電圧が 2.0 V (Typ) 以上になると、ディスチャージ MOS も OFF します。

2.5 サーマルシャットダウン機能 (TSD)

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路です。通常は許容損失範囲内で使用しますが、万が一許容損失を超えた状態が継続し、チップ温度 T_j が 175 °C (Typ) まで上昇すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、セットの温度保護機能として使用しないでください。

応用回路例

1 $V_{OUT} = 5.0 V$

Table 1. アプリケーション仕様

Parameter	Symbol	Specification Value
Input Voltage	V_{IN}	7 V ~ 48 V
Output Voltage	V_{OUT}	5.0 V
Switching Frequency	f_{OSC}	200 kHz (Typ)
Maximum Output Current	I_{OUTMAX}	5 A

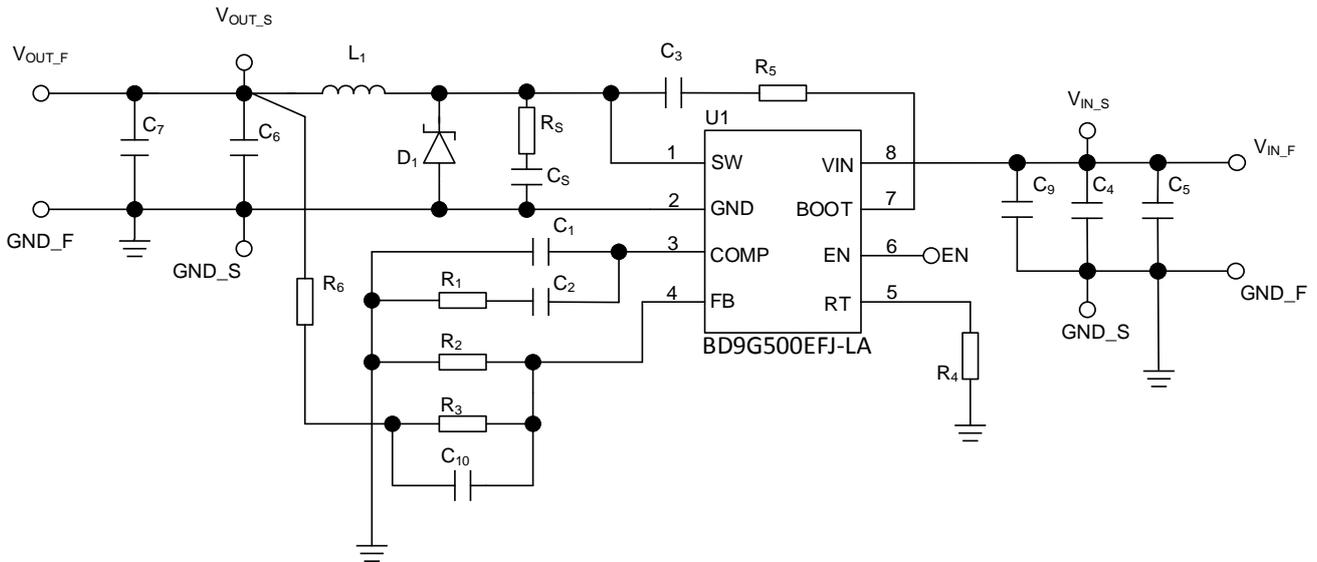


Figure 36. アプリケーション回路図

Table 2. 推奨部品定数^(Note 1) ($V_{OUT} = 5.0 V$)

Part No.	Value	Part Name	Manufacturer
C_4 ^(Note 2)	15 μF / 100 V	KRM55WR72A156MH01L	MURATA
C_9 ^(Note 3)	1 μF / 100 V	GRM21BC72A105KE01L	MURATA
C_3 ^(Note 4)	1 μF / 10 V	GRM155C71A105KE11D	MURATA
C_2	6800 pF / 50 V	GRM1555C1H682JE01D	MURATA
C_6	47 μF / 25 V	KRM55WR71E476MH01L	MURATA
C_7	220 μF / 50 V Aluminum	UBT1H221M	NICHICON
R_1	62 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_2	0.75 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_3	3 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_4	47 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_5	0 Ω	MCR03 series	ROHM
R_6	0 Ω	MCR03 series	ROHM
D_1	100 V / 10 A	STPS15H100C	ST
		RB088BM100TL	ROHM
L_1	33 μH	7443551331	WURTH

(Note 1) 出力リプル電圧及び負荷応答を重視した設定となっております。十分実機でのご確認をお願いします。
部品はテーブルにない場合、すべて OPEN です。

(Note 2) 入力コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性などを考慮して実容量が 4.7 μF を下回らないよう設定してください。

(Note 3) 高周波ノイズの影響を低減するために、1 μF のセラミック・コンデンサを VIN 端子と GND 端子の極力近くに配置してください。

(Note 4) ブーストラップコンデンサ C_3 は、温度特性、DC バイアス特性などを考慮して、実容量が 0.047 μF を下回らないよう設定してください。

1 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$ — 続き

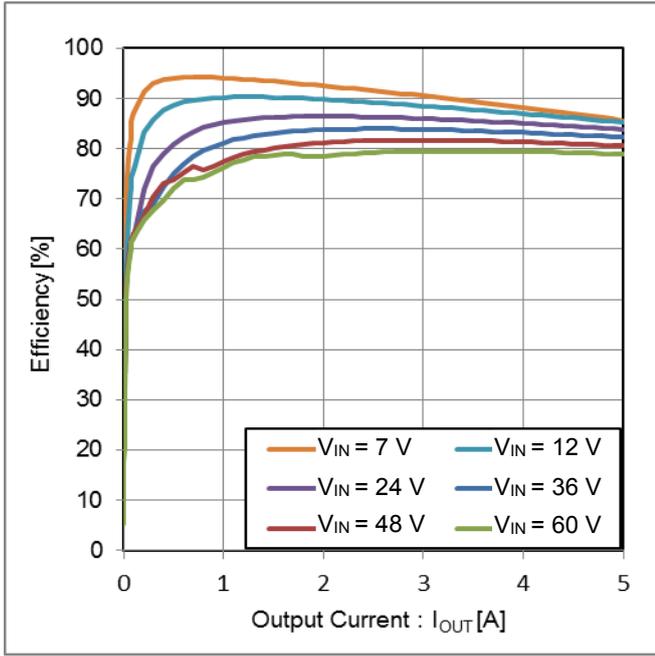


Figure 37. Efficiency vs Output Current

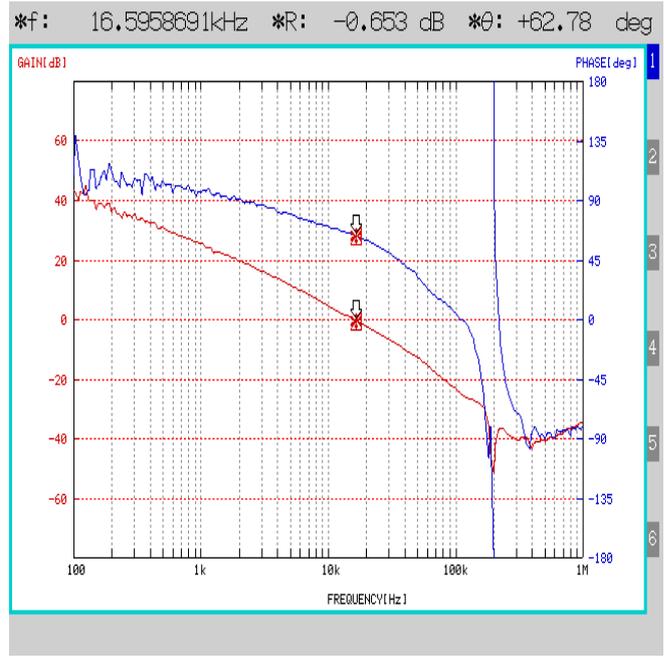


Figure 38. Frequency Characteristics
($I_{OUT} = 5.0\text{ A}$)

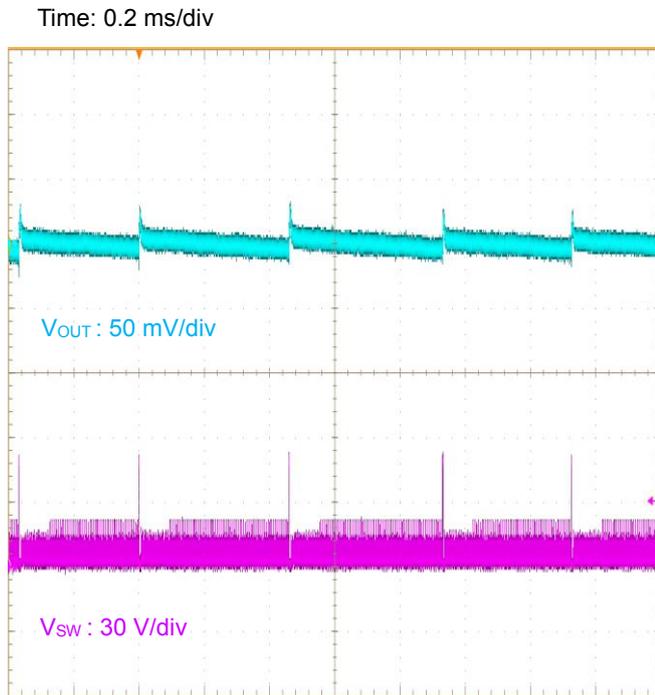


Figure 39. V_{OUT} Ripple
($I_{OUT} = 0\text{ A}$)

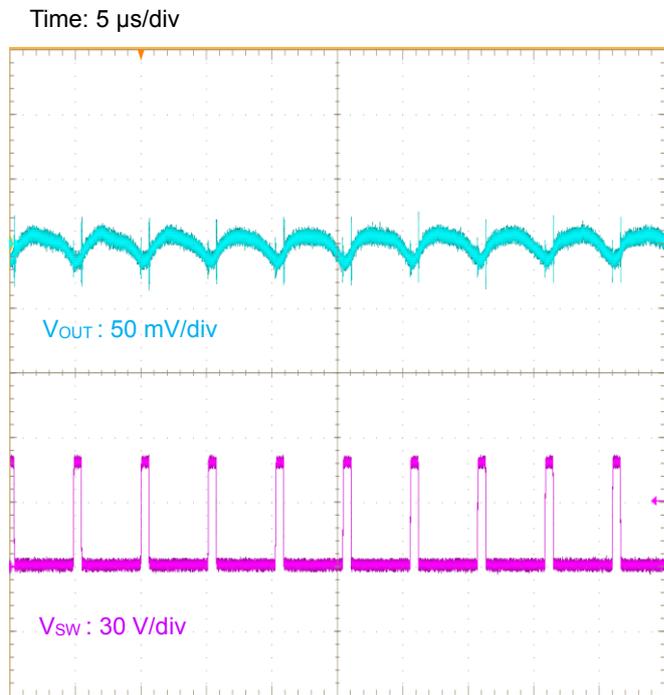


Figure 40. V_{OUT} Ripple
($I_{OUT} = 5.0\text{ A}$)

1 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$ — 続き



Figure 41. Load Transient Response
($I_{OUT} = 1.25\text{ A} - 3.75\text{ A}$)



Figure 42. Load Transient Response
($I_{OUT} = 0\text{ A} - 3.75\text{ A}$)

応用回路例 — 続き

2 $V_{OUT} = 3.3\text{ V}$

Table 3. アプリケーション仕様

Parameter	Symbol	Specification Value
Input Voltage	V_{IN}	7 V ~ 36 V
Output Voltage	V_{OUT}	3.3 V
Switching Frequency	f_{OSC}	200 kHz (Typ)
Maximum Output Current	I_{OUTMAX}	5 A

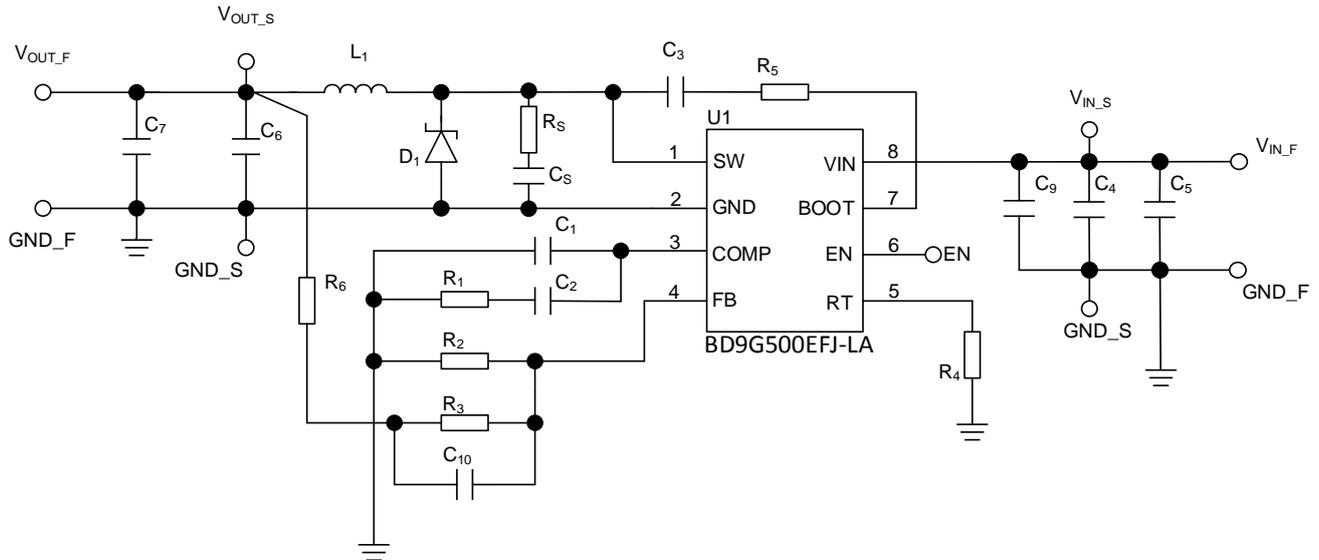


Figure 43. アプリケーション回路図

Table 4. 推奨部品定数^(Note 1) ($V_{OUT} = 3.3\text{ V}$)

Part No.	Value	Part Name	Manufacturer
C_4 ^(Note 2)	15 μF / 100 V	KRM55WR72A156MH01L	MURATA
C_9 ^(Note 3)	1 μF / 100 V	GRM21BC72A105KE01L	MURATA
C_3 ^(Note 4)	1 μF / 10 V	GRM155C71A105KE11D	MURATA
C_2	6800 pF / 50 V	GRM1555C1H682JE01D	MURATA
C_6	47 μF / 25 V	KRM55WR71E476MH01L	MURATA
C_7	220 μF / 50 V Aluminum	UBT1H221M	NICHICON
R_1	43 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_2	2.7 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_3	6.2 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_4	47 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_5	0 Ω	MCR03 series	ROHM
R_6	10 Ω	MCR03 series	ROHM
D_1	100 V / 10 A	STPS15H100C	ST
		RB088BM100TL	ROHM
L_1	33 μH	7443551331	WURTH

(Note 1) 出力リップル電圧及び負荷応答を重視した設定となっております。十分実機でのご確認をお願いします。

部品はテーブルにない場合、すべて OPEN です。

(Note 2) 入力コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性などを考慮して実容量が 4.7 μF を下回らないよう設定してください。

(Note 3) 高周波ノイズの影響を低減するために、1 μF のセラミック・コンデンサを VIN 端子と GND 端子の極力近くに配置してください。

(Note 4) ブーストラップコンデンサ C_3 は、温度特性、DC バイアス特性などを考慮して、実容量が 0.047 μF を下回らないように設定してください。

2 $V_{OUT} = 3.3\text{ V}$ — 続き

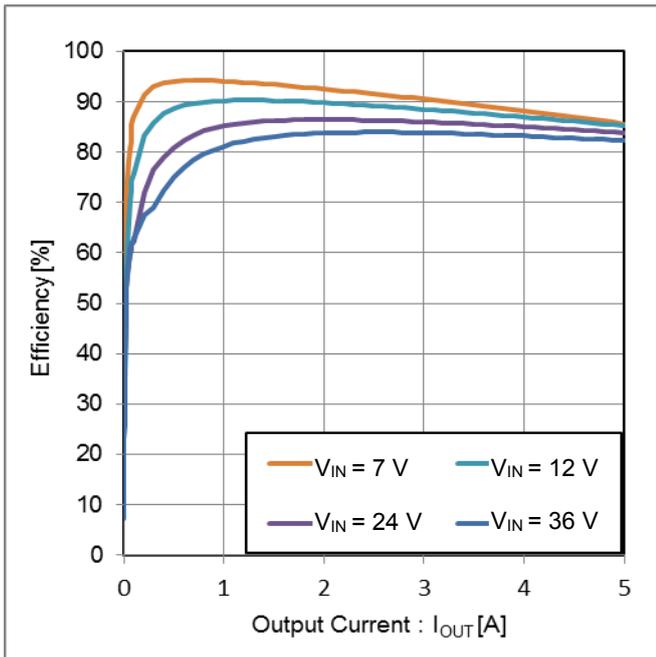


Figure 44. Efficiency vs Output Current

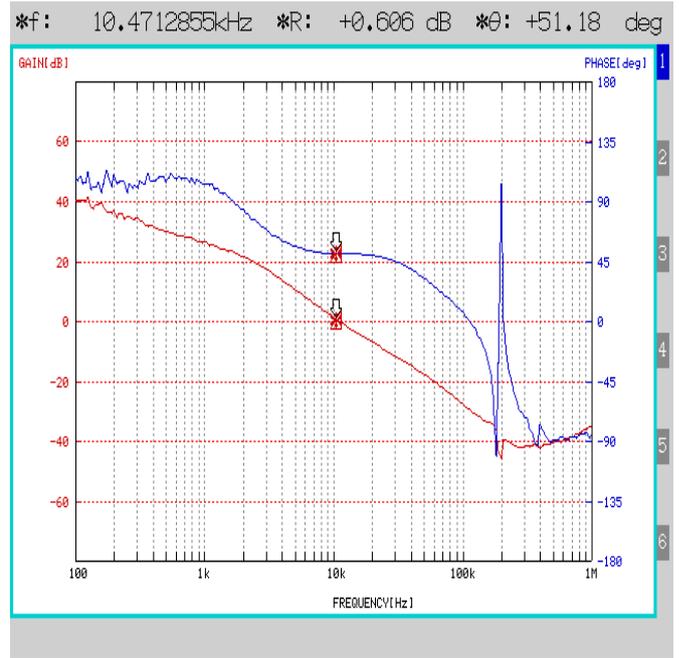


Figure 45. Frequency Characteristics ($I_{OUT} = 5.0\text{ A}$)

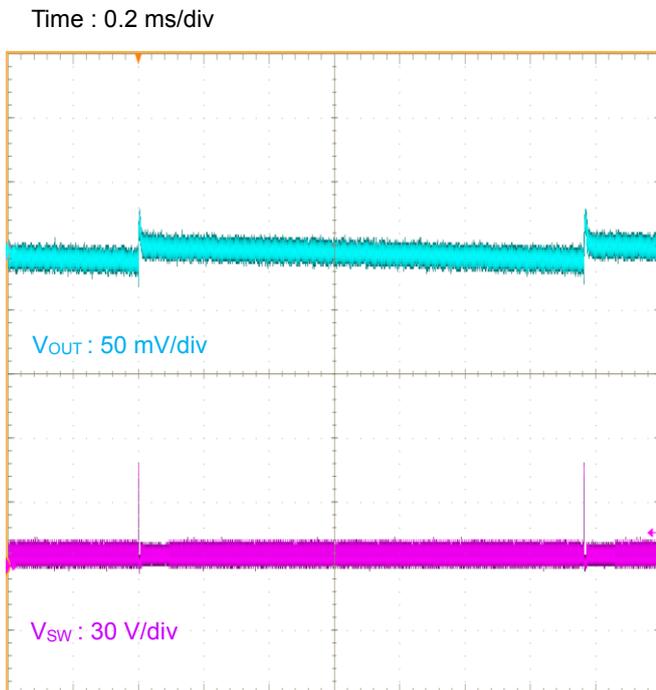


Figure 46. V_{OUT} Ripple ($I_{OUT} = 0\text{ A}$)

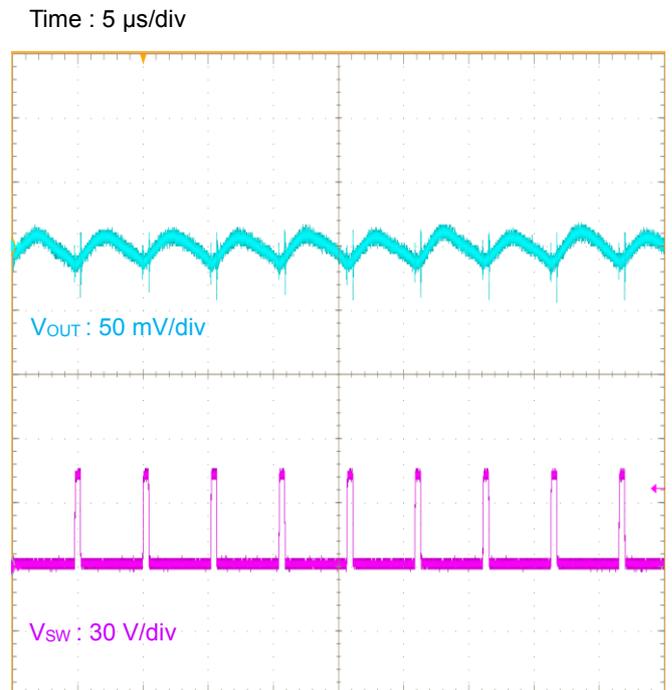


Figure 47. V_{OUT} Ripple ($I_{OUT} = 5.0\text{ A}$)

2 $V_{OUT} = 3.3\text{ V}$ — 続き



Figure 48. Load Transient Response
 ($V_{IN} = 36\text{ V}$, $I_{OUT} = 1.25\text{ A} - 3.75\text{ A}$)

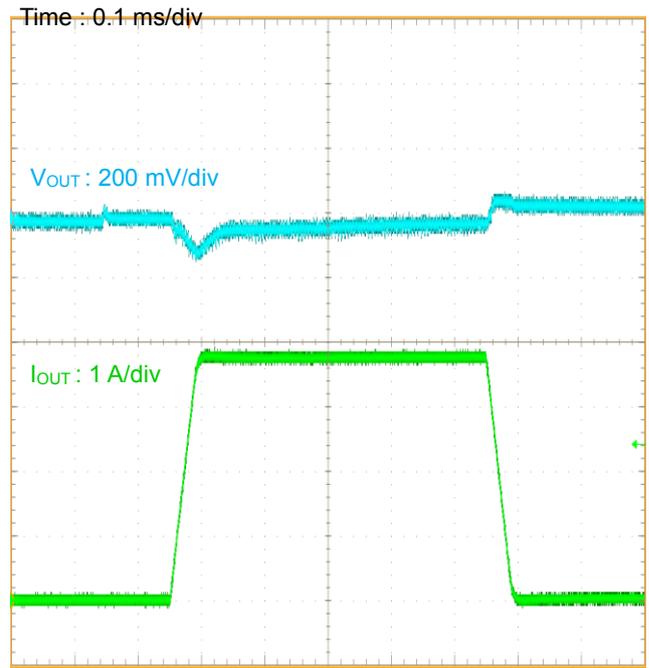


Figure 49. Load Transient Response
 ($V_{IN} = 36\text{ V}$, $I_{OUT} = 0\text{ A} - 3.75\text{ A}$)

応用回路例 — 続き

3 $V_{OUT} = 12\text{ V}$

Table 5. アプリケーション仕様

Parameter	Symbol	Specification Value
Input Voltage	V_{IN}	18 V ~ 60 V
Output Voltage	V_{OUT}	12 V
Switching Frequency	f_{OSC}	200 kHz (Typ)
Maximum Output Current	I_{OUTMAX}	5 A

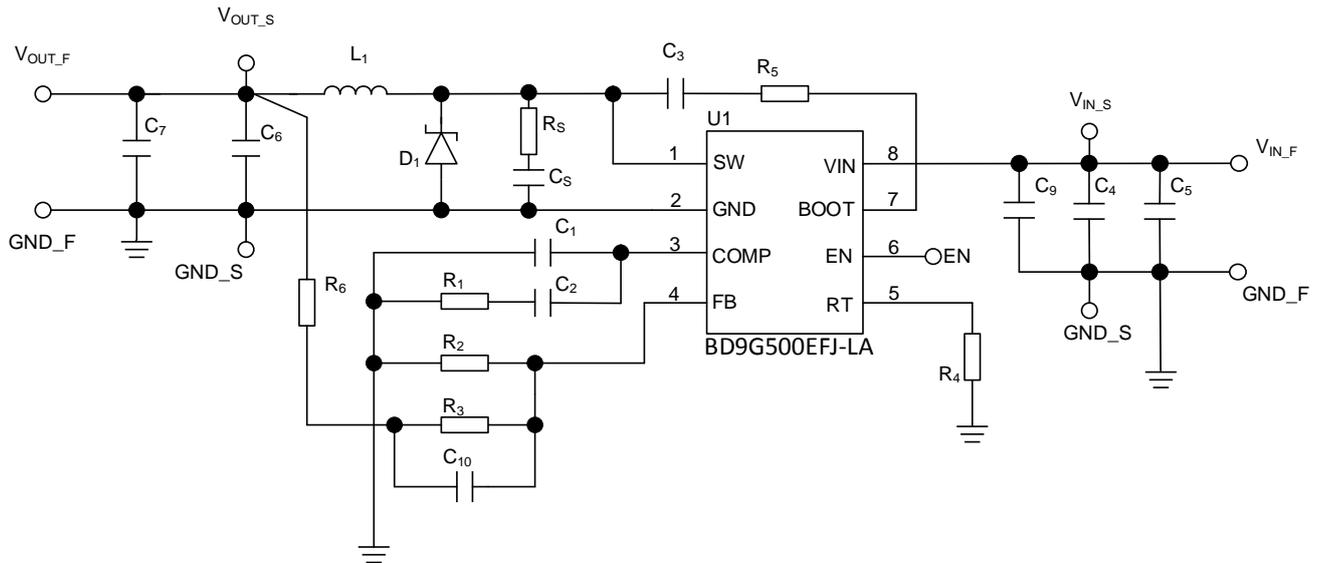


Figure 50. アプリケーション回路図

Table 6. 推奨部品定数^(Note 1) ($V_{OUT} = 12\text{ V}$)

Part No.	Value	Part Name	Manufacturer
C_4 ^(Note 2)	15 μF / 100 V	KRM55WR72A156MH01L	MURATA
C_9 ^(Note 3)	1 μF / 100 V	GRM21BC72A105KE01L	MURATA
C_3 ^(Note 4)	1 μF / 10 V	GRM155C71A105KE11D	MURATA
C_2	6800 pF / 50 V	GRM1555C1H682JE01D	MURATA
C_6	47 μF / 25 V	KRM55WR7YA476MH01L	MURATA
C_7	220 μF / 50 V Aluminum	UBT1H221M	NICHICON
R_1	150 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_2	0.3 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_3	3.3 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_4	47 k Ω	MCR03 series	ROHM
R_5	0 Ω	MCR03 series	ROHM
R_6	0 Ω	MCR03 series	ROHM
D_1	100 V / 10 A	STPS15H100C	ST
		RB088BM100TL	ROHM
L_1	33 μH	7443551331	WURTH

(Note 1) 出力リプル電圧及び負荷応答を重視した設定となっております。十分実機でのご確認をお願いします。

部品はテーブルにない場合、すべて OPEN です。

(Note 2) 入力コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性などを考慮して実容量が 4.7 μF を下回らないよう設定してください。

(Note 3) 高周波ノイズの影響を低減するために、1 μF のセラミック・コンデンサを VIN 端子と GND 端子の極力近くに配置してください。

(Note 4) ブーストラップコンデンサ C_3 は、温度特性、DC バイアス特性などを考慮して、実容量が 0.047 μF を下回らないよう設定してください。

3 $V_{OUT} = 12\text{ V}$ — 続き

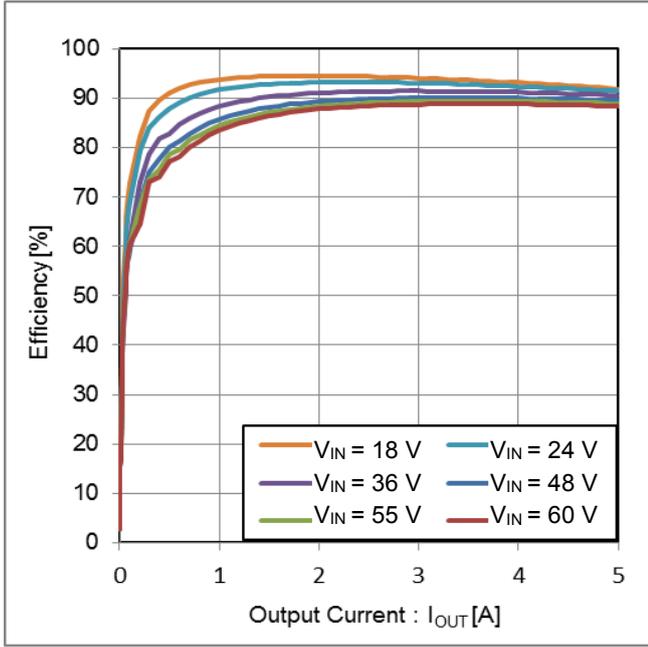


Figure 51. Efficiency vs Output Current

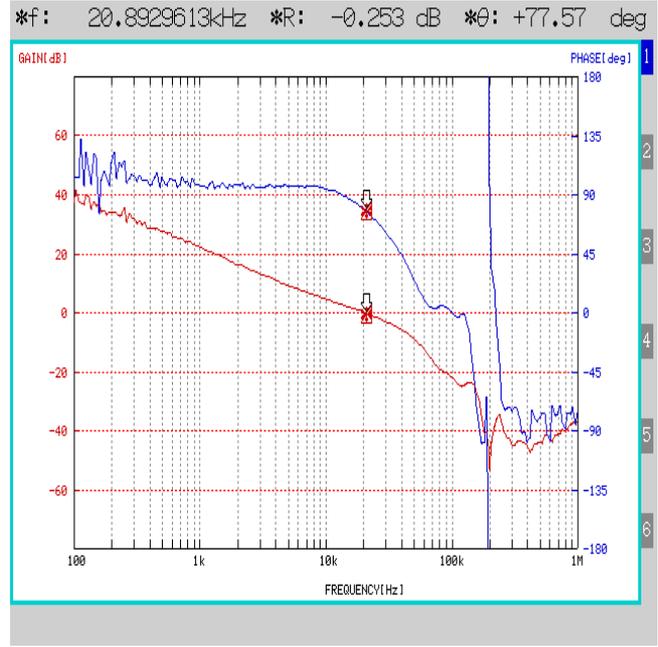


Figure 52. Frequency Characteristics
($I_{OUT} = 5.0\text{ A}$)

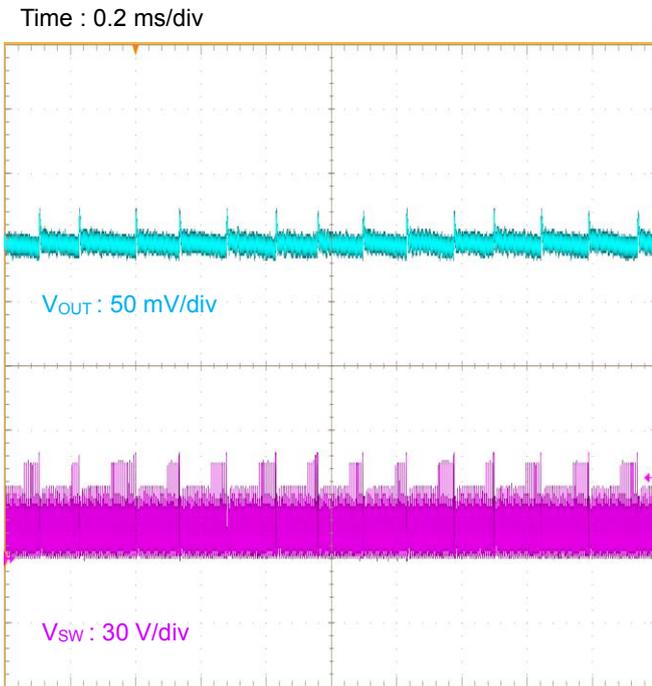


Figure 53. V_{OUT} Ripple
($I_{OUT} = 0\text{ A}$)

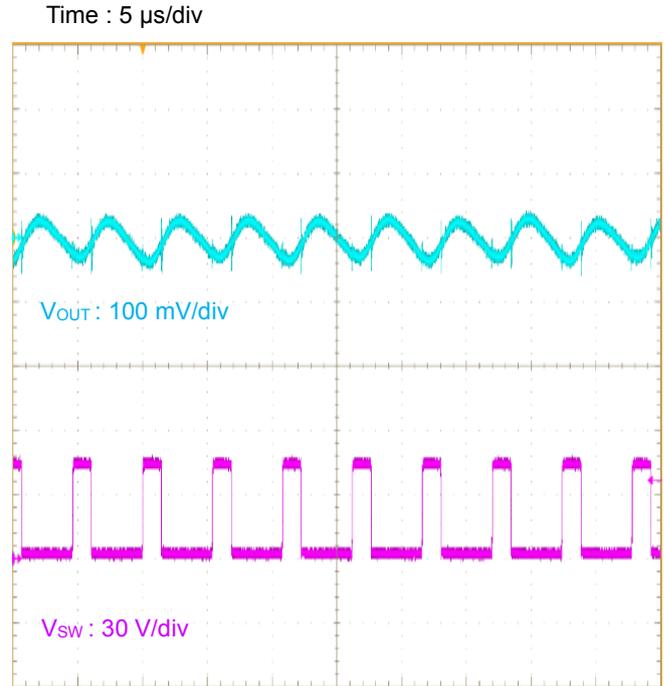


Figure 54. V_{OUT} Ripple
($I_{OUT} = 5.0\text{ A}$)

3 $V_{OUT} = 12\text{ V}$ — 続き

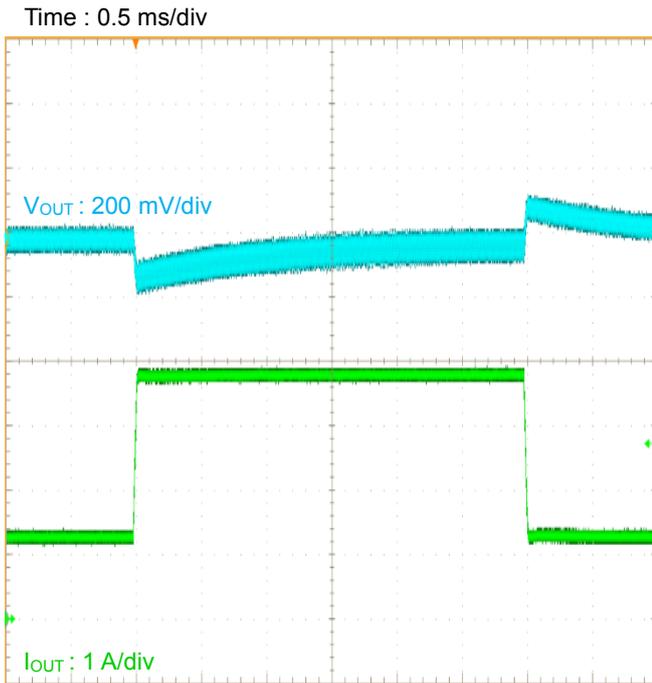


Figure 55. Load Transient Response
($I_{OUT} = 1.25\text{ A} - 3.75\text{ A}$)

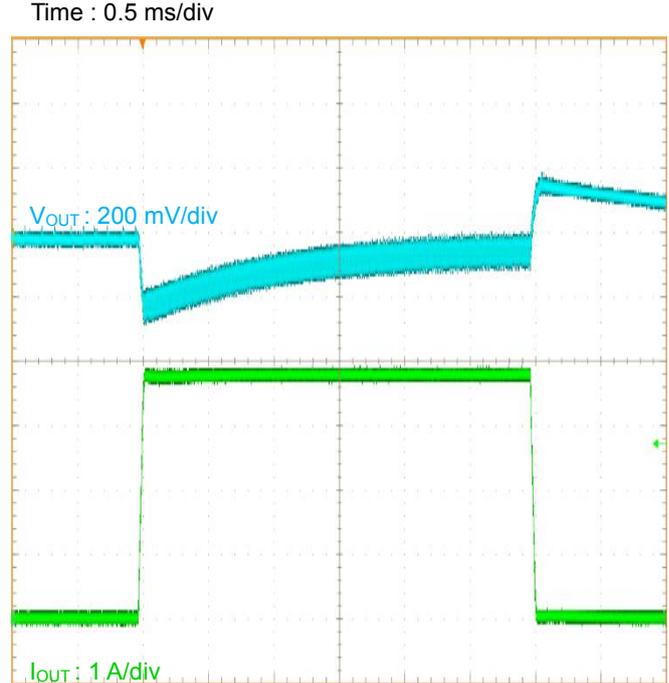


Figure 56. Load Transient Response
($I_{OUT} = 0\text{ A} - 3.75\text{ A}$)

アプリケーション部品選定方法

応用回路例に示す推奨定数以外の設定をご使用の場合、弊社までお問い合わせください。

1 スイッチング周波数

BD9G500EFJ-LA は RT 端子に接続する抵抗値によりスイッチング周波数を 100 kHz ~ 650 kHz の間で任意に決定することが可能です。f_{OSC} [kHz], R_{RT} [kΩ] の設定に関しては下記の計算式のように求められます。

R_{RT} (kΩ) = 47 kΩ の場合、スイッチング周波数は 200 kHz (Typ) となります。

$$R_{RT}(k\Omega) = \frac{18423}{f_{OSC}(kHz)^{1.127}}$$

$$f_{OSC}(kHz) = \frac{6093.5}{R_{RT}(k\Omega)^{0.887}}$$

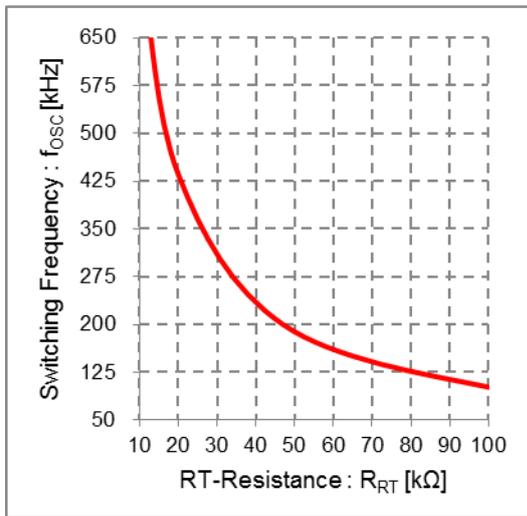


Figure 57. Switching Frequency vs RT-Resistance

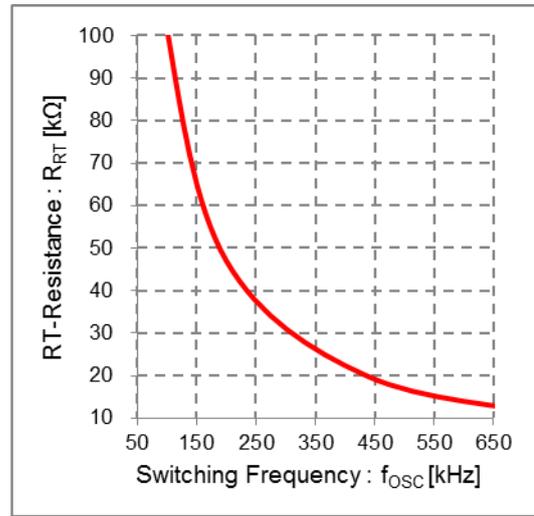


Figure 58. RT-Resistance vs Switching Frequency

2 出力 LC フィルタ定数

DC/DC コンバータでは負荷に連続的な電流を供給するために、出力電圧の平滑化用の LC フィルタが必要です。インダクタンス値の大きなコイルを選択するとコイルに流れるリップル電流 ΔI_L が小さくなり、出力電圧に発生するリップル電圧が小さくなりますが負荷過渡応答特性は遅くなります。インダクタンス値の小さなコイルを選択すると、過渡応答特性は速くなりますがコイルのリップル電流が大きくなり、出力電圧におけるリップル電圧が大きくなるというトレードオフの関係になります。

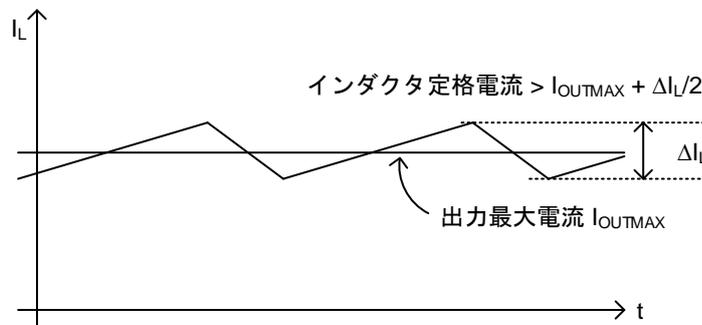


Figure 59. インダクタに流れる電流波形

2 出力 LC フィルタ定数 – 続き

$V_{IN} = 48 \text{ V}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, $L = 33 \text{ } \mu\text{H}$, スイッチング周波数 $f_{OSC} = 200 \text{ kHz}$ で計算するとコイルリップル電流 ΔI_L は次式になります。

$$\Delta I_L = V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT}) \times \frac{1}{V_{IN} \times f_{OSC} \times L} = 679 \text{ [mA]}$$

使用するコイルの飽和電流は、最大出力電流にコイルリップル電流 ΔI_L の 1/2 を足し合わせた電流よりも大きいものを選択してください。出力コンデンサ C_{OUT} は、出力リップル電圧特性に影響を与えます。必要とされるリップル電圧特性を満たせるように出力コンデンサ C_{OUT} を選定してください。

出力リップル電圧は次式で表されます。

$$\Delta V_{RPL} = \Delta I_L \times \left(R_{ESR} + \frac{1}{8 \times C_{OUT} \times f_{OSC}} \right) \quad [\text{V}]$$

ここで R_{ESR} は出力コンデンサの等価直列抵抗
 $C_{OUT} = 267 \text{ } \mu\text{F}$, $R_{ESR} = 30 \text{ m}\Omega$ とすると、出力リップル電圧は

$$\Delta V_{RPL} = 0.679 \times \left(30 \text{ m}\Omega + \frac{1}{8 \times 267 \mu \times 200 \text{ k}} \right) = 21.96 \text{ [mV]}$$

と計算されます。

出力コンデンサ C_{OUT} の値を選定する際は、 C_{OUT} 以外に V_{OUT} に接続されるコンデンサ値 C_{LOAD} に注意してください。 C_{OUT} 以外に V_{OUT} に接続可能な最大コンデンサ値 $C_{LOAD}(\text{Max})$ は下の条件式より算出してください。起動時のコイルリップル電流最大値 I_{L_START} が電流制限スレッショルド $6.4 \text{ A}(\text{Min})$ より小さくする必要がありません。

起動時のコイルリップル電流最大値 (I_{L_START}) は次式で表されます。

$$I_{L_START} = I_{OUTMAX} + \left(\frac{\Delta I_L}{2} \right) + I_{CAP} \quad [\text{A}]$$

また、出力コンデンサへの充電電流は次式で表されます。

$$I_{CAP} = \frac{(C_{OUT} + C_{LOAD}) \times V_{OUT}}{t_{SS}} \quad [\text{A}]$$

上式より、 $V_{IN} = 48 \text{ V}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, $L = 33 \text{ } \mu\text{H}$, $I_{OUTMAX} = 5 \text{ A}(\text{Max})$, スイッチング周波数 $f_{OSC} = 180 \text{ kHz}(\text{Min})$, 出力コンデンサ $C_{OUT} = 267 \text{ } \mu\text{F}$, ソフトスタート時間 $t_{SS} = 15 \text{ ms}(\text{Min})$ 時の計算は次式になります。

$$C_{LOAD}(\text{Max}) \leq \frac{\left(6.4 - I_{OUTMAX} - \frac{\Delta I_L}{2} \right) \times t_{SS}}{V_{OUT}} - C_{OUT} = 2801 \text{ [}\mu\text{F]}$$

3 キャッチ・ダイオード

BD9G500EFJ-LA は、SW と GND の間に外付けのキャッチ・ダイオードを接続する必要があります。アプリケーションの最大入力電圧以上の逆方向耐圧を持つショットキーバリアダイオードを選択してください。また、最大出力電流はコイルリップル電流 ΔI_L の 1/2 を足し合わせた電流よりも大きいものを選択してください。

4 ブートストラップコンデンサ

ブートストラップコンデンサ C_3 の値は $1 \text{ } \mu\text{F}$ を推奨します。SW ピンと BOOT ピンの間に接続してください。ブートストラップコンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性、等を考慮して実容量が $0.047 \text{ } \mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

アプリケーション部品選定方法 — 続き

5 出力電圧設定

フィードバック抵抗比によって出力電圧値を設定できます。

$$V_{OUT} = \frac{R_6 + R_2 + R_3}{R_2} [V]$$

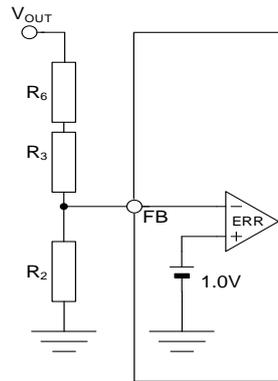


Figure 60. フィードバック抵抗回路

6 入力コンデンサ

入力コンデンサは、セラミック・コンデンサをご使用ください。通常の設定においては 15 μ F が推奨とされますが、より大きな値を使用すると、入力電圧リップルをさらに低減できます。また、入力コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性等を考慮して最小値を 4.7 μ F より下回らないように設定してください。

7 位相補償部品

電流モード制御の降圧 DC/DC コンバータは、ERR アンプと負荷によって形成される 2 つのポールと、位相補償にて付加する 1 つのゼロ点を持つ 2-pole 1-zero システムです。位相補償抵抗 R_1 は、DC/DC コンバータのループゲインが 0 dB となる、クロスオーバー周波数 f_{CRS} を決定します。このクロスオーバー周波数 f_{CRS} を高く設定した場合、良好な過渡負荷応答特性が得られますが、安定性において不利になります。一方、クロスオーバー周波数 f_{CRS} を低く設定した場合は、非常に安定した特性になりますが、過渡負荷応答特性において劣ります。

7.1 位相補償抵抗 R_1 の選定

位相補償抵抗 R_1 は、次式にて求めることができます。

$$R_1 = \frac{2 \times \pi \times V_{OUT} \times f_{CRS} \times C_{OUT}}{V_{FB} \times G_{MP} \times G_{MA}} [\Omega]$$

V_{OUT} : 出力電圧

f_{CRS} : クロスオーバー周波数

C_{OUT} : 出力コンデンサ

V_{FB} : フィードバック基準電圧 (1.0 V (Typ))

G_{MP} : カレントセンスゲイン (14 A/V (Typ))

G_{MA} : ERR アンプトランスコンダクタンス (200 μ A/V (Typ))

7.2 位相補償容量 C_2 の選定

DC/DC コンバータを安定動作させるために、負荷によって形成されるポールによる位相遅れをキャンセルするゼロ点 (位相進み) を位相補償容量 C_2 にて決定します。

クロスオーバー周波数の 1/9 以下の位置にゼロ点を挿入することで、多くの場合良好な特性が得られます。

位相補償容量 C_2 は、次式にて求めることができます。

$$C_2 = \frac{1}{2 \times \pi \times R_1 \times f_Z} [F]$$

f_Z : 挿入されるゼロ点

7.3 ループ安定性について

DC/DC コンバータの安定性を確保するため、十分な位相マージンを持っていることを実機にて確認してください。ワースト条件において、45°以上の位相マージンを確保することを推奨します。実際には、PCB のレイアウトや配線の引き回し、使用する部品の種類、使用条件 (温度など) により特性は変化します。実機での周波数特性の確認には、ゲインフェーズアナライザや周波数特性分析器を使用します。測定方法などは各測定器メーカーにお問い合わせください。

PCB レイアウト設計について

DC/DC コンバータの設計において PCB レイアウトの設計は回路設計と同じだけ重要です。適切なレイアウトにより、電源回路に関する様々な問題を回避することができます。Figure 66-a から 66-c は降圧 DC/DC コンバータの電流経路を示した図です。Figure 66-a の Loop1 は High Side の switch が ON 時にコンバータに流れる電流を表しており、Figure 66-b の Loop2 は High Side の switch が OFF 時にコンバータに流れる電流を表しています。Figure 66-c の太線は Loop1 と Loop2 の差分を表しています。switch がオフからオンへ、オンからオフへ変化するたびに太線部分の電流は激しく変化します。この系は変化が急峻なため高周波を多く含んだ波形が現れます。そのため入力コンデンサと IC で構成される太線部の面積をできるだけ小さくすることで、ノイズを減らすことができます。詳細につきましてはスイッチングレギュレータシリーズのアプリケーションノート「降圧コンバータの PCB レイアウト手法」をご参照ください。

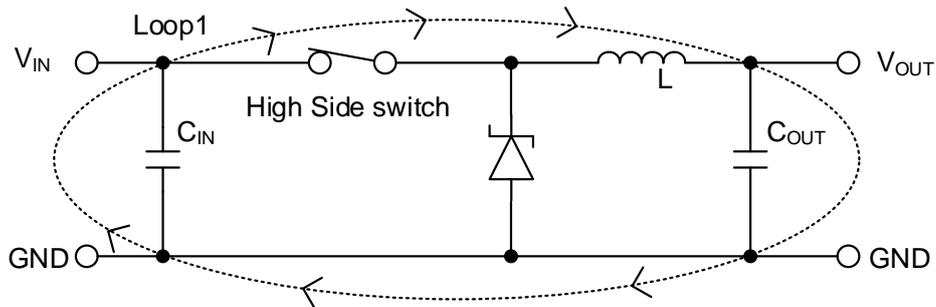


Figure 61-a. High Side switch: ON 時の電流経路

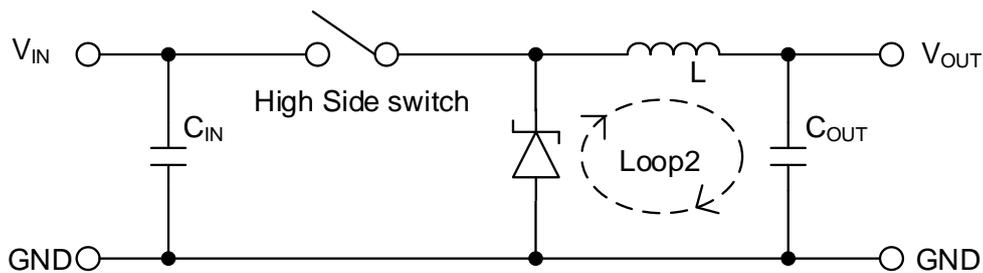


Figure 61-b. High Side switch: OFF 時の電流経路

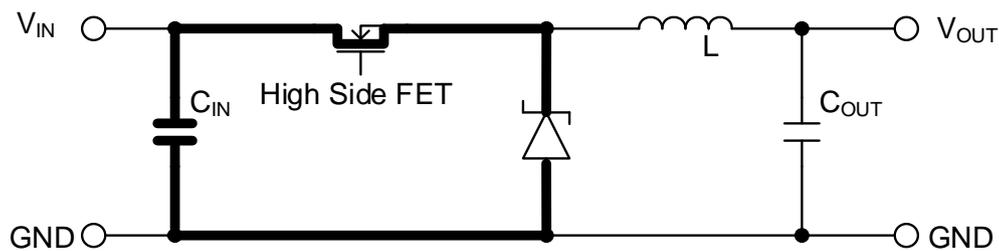
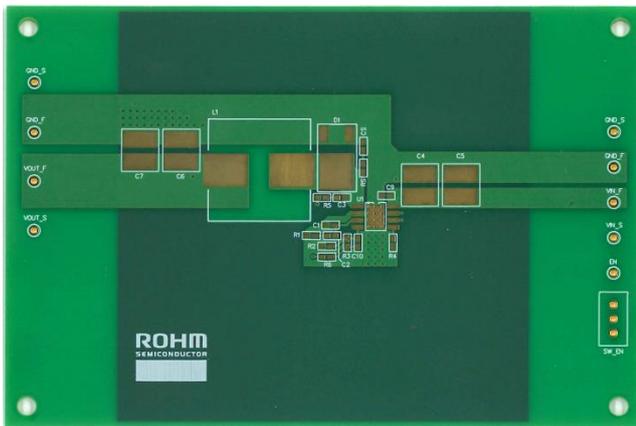


Figure 61-c. 電流の差分、レイアウト上での重要箇所

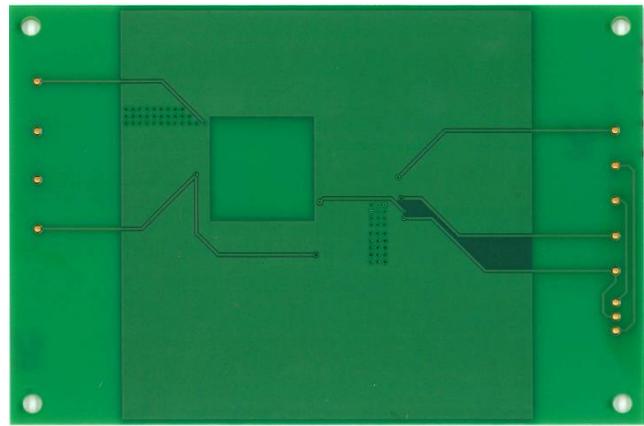
PCB レイアウト設計について — 続き

PCB レイアウトを設計する際には、以下に挙げる点を特に注意して設計してください。

- ・入力コンデンサは IC の VIN 端子に可能な限り近く、IC と同じ面に配置してください。
- ・PCB 上に使用していないエリアがある場合は、IC や周辺部品の放熱を助けるため、グラウンドノードの銅箔プレーンを配置してください。
- ・SW などのスイッチングノードは、他ノードへの AC 結合によるノイズの影響が懸念されるため、コイルとキャッチ・ダイオードに可能な限り太く短くトレースしてください。
- ・FB、COMP につながるラインは、SW のノードとは可能な限り離してください。
- ・出力コンデンサは、入力から高調波ノイズの影響を避けるため、入力コンデンサから離して配置してください。



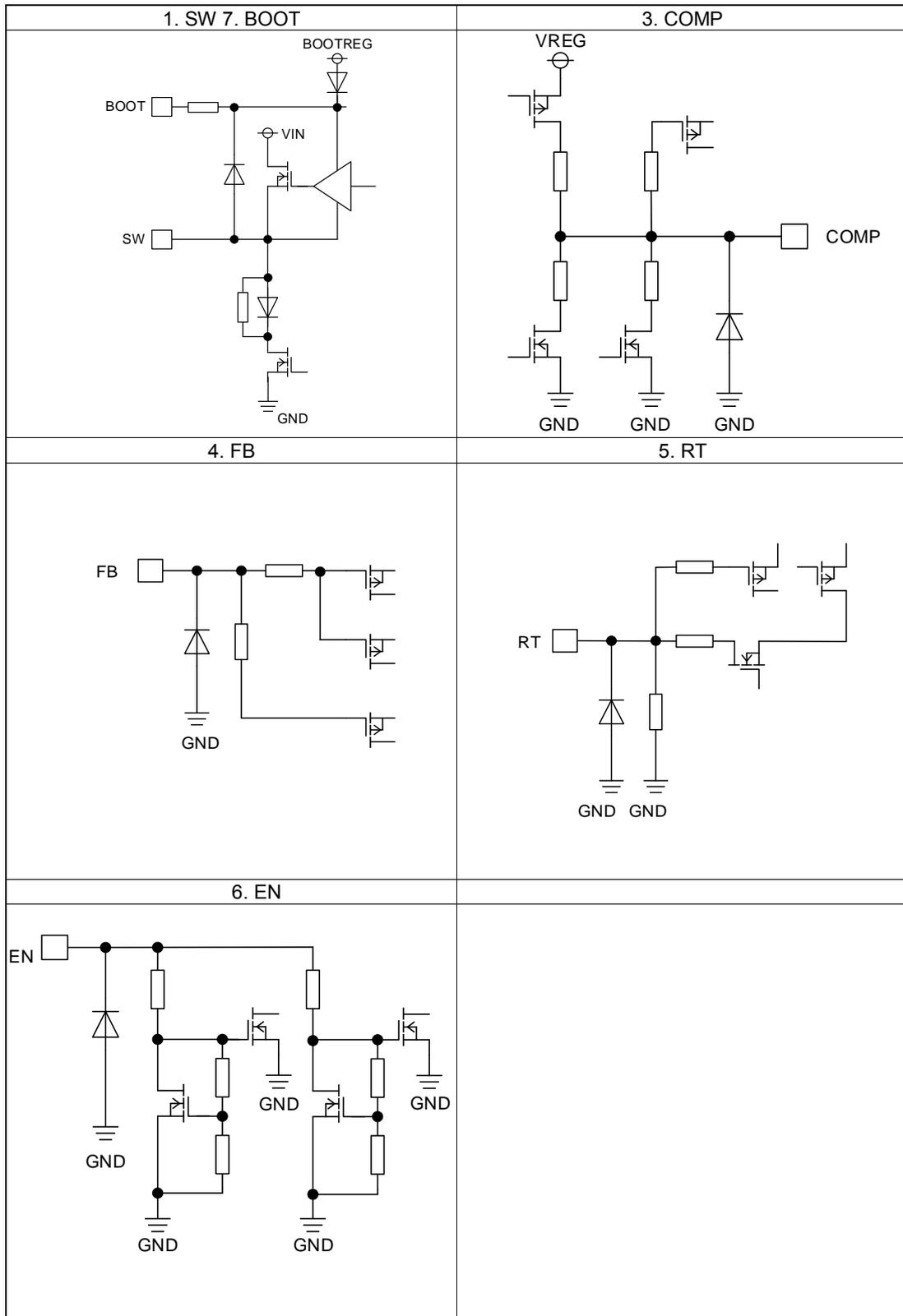
表面



裏面

Figure 62. サンプルボードレイアウトパターン例

入出力等価回路図



使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

L 負荷駆動端子（例：モータドライバの出力、DC-DC コンバータの出力など）については、L 負荷の逆起電圧の影響でグラウンド以下に振れることが考えられます。L 負荷駆動端子が逆起電圧によって負電位になる場合を除き、グラウンド端子はいかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子、L 負荷駆動端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。使用条件、環境及び L 負荷個々の特性によっては誤動作などの不具合が発生する可能性があります。IC の動作などに問題のないことを十分ご確認ください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

6. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

7. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低い端子にコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

8. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

9. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

使用上の注意 — 続き

10. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、 $GND > (\text{端子 A})$ の時、トランジスタ (NPN) では $GND > (\text{端子 B})$ の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ (NPN) では、 $GND > (\text{端子 B})$ の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND (P 基板) より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

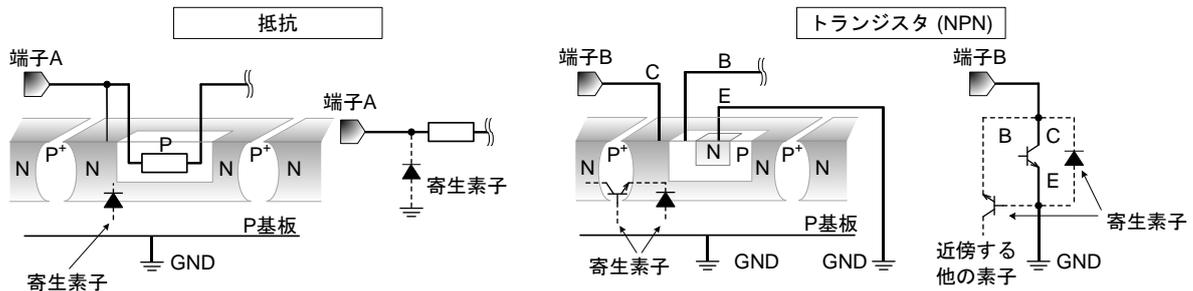


Figure 63. モノリシック IC 構造例

11. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ、定数を決定してください。

12. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

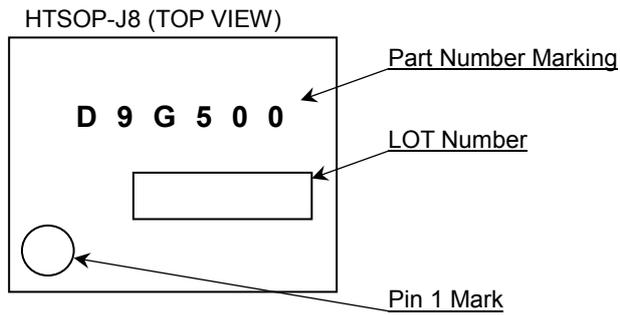
13. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

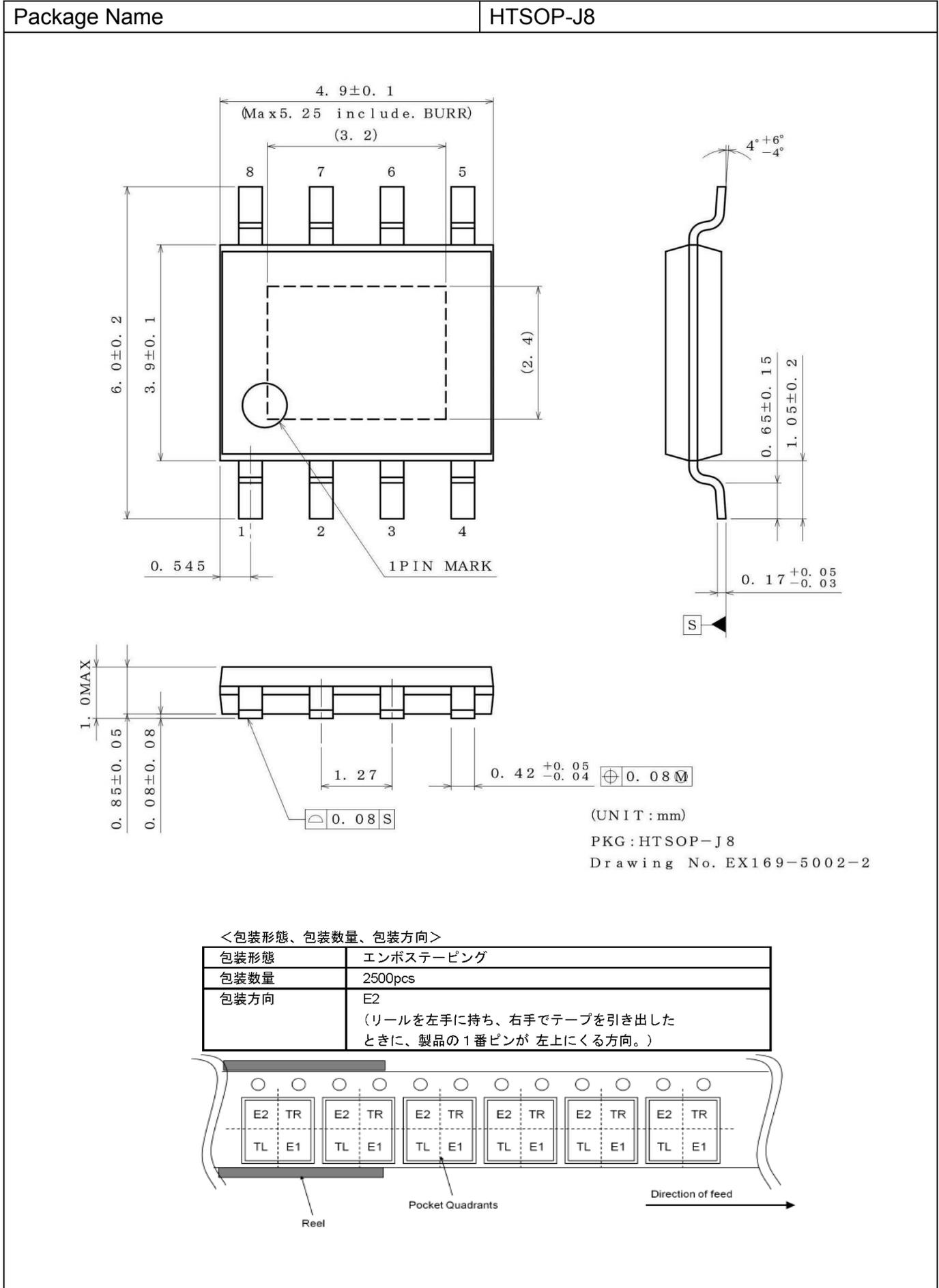
発注形名情報



標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様



改訂履歴

日付	版	変更内容
2020.06.11	001	新規作成

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

- 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

- 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
- 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧結露するような場所でのご使用
- 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
- 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
- パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
- 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
- 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
- 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

- ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
- はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ① 潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ② 推奨温度、湿度以外での保管
 - ③ 直射日光や結露する場所での保管
 - ④ 強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。